

XII Российская конференция
по физике полупроводников

Ершово, 21-25 сентября 2015 г

Программа

Физический институт им. П. Н. Лебедева РАН
Москва 2015

ХII Российская конференция по физике полупроводников (Полупроводники 2015)

Организаторы и партнеры:

Физический институт
им. П. Н. Лебедева РАН



Институт радиотехники
и электроники
им. В. А. Котельникова
РАН

Физический факультет
МГУ
им. М. В. Ломоносова



Научный совет по физике
полупроводников,
Отделение физических
наук РАН

mikron
ОАО «НИИМЭ и Микрон»

ОАО
«НИИ молекулярной
электроники и завод
«Микрон»



РОСНАНО

ФОНД ИНФРАСТРУКТУРНЫХ
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ



ООО
«Триумфф сервис»

Финансовая поддержка

Организаторы глубоко признательны за поддержку конференции:

Российской
Академии
наук



Российскому фонду
фундаментальных
исследований

ФАНО России



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
НАУЧНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ООО
«Брукер»



RTI
КРИОМАГНИТНЫЕ СИСТЕМЫ

ООО «РТИ,
Криомагнитные системы»

Сайт конференции <http://semicond-2015.lebedev.ru/>

Программный комитет

Е. Л. Ивченко, *председатель*, ФТИ им. А. Ф. Иоффе РАН, Санкт-Петербург
И. П. Акимченко, *ученый секретарь*,
Научный совет по физике полупроводников РАН, Москва

Ж. И. Алферов	СПб АУ НОЦНТ РАН	Санкт-Петербург
А. А. Андронов	ИФМ РАН	Н. Новгород
А. Л. Асеев	ИФП СО РАН	Новосибирск
В. А. Волков	ИРЭ РАН	Москва
С. В. Гапонов	ИФМ РАН	Н. Новгород
А. А. Гиппиус	ФИАН	Москва
М. М. Глазов	ФТИ РАН	Санкт-Петербург
А. А. Горбачевич	ФИАН	Москва
А. В. Двуреченский	ИФП СО РАН	Новосибирск
В. С. Днепровский	МГУ	Москва
А. Г. Забродский	ФТИ РАН	Санкт-Петербург
С. В. Зайцев-Зотов	ИРЭ РАН	Москва
А. А. Каплянский	ФТИ РАН,	Санкт-Петербург
В. В. Кведер	ИФТТ РАН	Черноголовка
Л. В. Келдыш	ФИАН	Москва
П. С. Копьев	ФТИ РАН	Санкт-Петербург
З. Ф. Красильник	ИФМ РАН	Н. Новгород
Г. Я. Красников	ОАО «НИИМЭ и «Микрон»	Зеленоград
И. В. Кукушкин	ИФТТ РАН	Черноголовка
В. Д. Кулаковский	ИФТТ РАН	Черноголовка
Л. В. Кулик	ИФТТ РАН	Черноголовка
Ю. Г. Кусраев	ФТИ РАН	Санкт-Петербург
А. В. Латышев	ИФП СО РАН	Новосибирск
И. Г. Неизвестный	ИФП СО РАН	Новосибирск
В. И. Окулов	ИФМ УрО РАН	Екатеринбург
В. Я. Покровский	ИРЭ РАН	Москва
А. А. Саранин	ИАПУ ДВО РАН	Владивосток
Н. Н. Сибельдин	ФИАН	Москва
Р. А. Сурис	ФТИ РАН	Санкт-Петербург
А. С. Терехов	ИФП СО РАН	Новосибирск
В. Б. Тимофеев	ИФТТ РАН	Черноголовка
В. М. Устинов	ФТИ РАН	Санкт-Петербург
Д. Р. Хохлов	МГУ	Москва
А. В. Чаплик	ИФП СО РАН	Новосибирск
В. И. Шашкин	ИФМ РАН	Н. Новгород

Организационный комитет

Н. Н. Сибельдин, <i>председатель</i> , ФИАН,		Москва
А. А. Горбачевич, <i>заместитель председателя</i> , ФИАН,		Москва
Д. Р. Хохлов, <i>заместитель председателя</i> , МГУ,		Москва
А. А. Пручкина, <i>ученый секретарь</i> , ФИАН,		Москва
Ю. А. Алещенко	ФИАН	Москва
Б. А. Аронзон	НИЦ «КИ» и ФИАН	Москва
Т. М. Бурбаев	ФИАН	Москва
В. А. Волков	ИРЭ РАН	Москва
В. И. Гавриленко	ИФМ РАН	Н. Новгород
А. А. Гиппиус	ФИАН	Москва
А. В. Двуреченский	ИФП СО РАН	Новосибирск
В. А. Дравин	ФИАН	Москва
В. А. Заяц	ОФН РАН	
А. Г. Итальянцев	ОАО «НИИМЭ и «Микрон»	Зеленоград
О. А. Клименко	ФИАН	Москва
П. С. Копьев	ФТИ РАН	Санкт-Петербург
М. В. Кочиев	ФИАН	Москва
А. В. Кулешов	ФИАН	Москва
И. В. Кучеренко	ФИАН	Москва
Ю. А. Митягин	ФИАН	Москва
В. И. Окулов	ИФМ УрО РАН	Екатеринбург
Л. С. Подлесных	ФИАН	Москва
Т. А. Романова	ФИАН	Москва
А. И. Шарков	ФИАН	Москва

Общая информация

Время и место проведения

Конференция проводится с 21 по 25 сентября в доме отдыха «Ершово» (Село Ершово, Одинцовского р-на Московской области).

Организационный взнос

Организационный взнос на участие в XII Российской конференции по физике полупроводников установлен в следующих размерах:

	Оплата до 22 июня 2015г.	Оплата с 23 по 30 июля
Для участников конференции	16 000 руб.	18 000 руб.
Для студентов и аспирантов	12 000 руб.	14 000 руб.
Для сопровождающих лиц	12 000 руб.	14 000 руб.
Для участников, не проживающих в ЛОП «Ершово»	4 000 руб.	5 000 руб.

Организационный взнос включает: оплату материалов конференции, оплату проживания в двухместном номере в ЛОП «Ершово» во время конференции (с 17:00 20 сентября до 15:00 25 сентября 2015 г.), трехразовое питание «шведский стол», кофе-брейки, частичную компенсацию стоимости банкета и экскурсий.

Транспорт

- от **Белорусского вокзала** на электричке до станции «**Звенигород**» (время в пути 1 час 10 минут), далее автобус № **25** до остановки «**Дом отдыха Ершово**» (время в пути 15-20 минут).

Расписание движения электропоездов до ст. Звенигород

<i>Отправление из Москвы</i>	<i>Прибытие в Звенигород</i>	<i>Отправление из Звенигорода</i>	<i>Прибытие в Москву</i>
04:36	05:59	04:50	06:11
06:12	07:29	05:16	06:36
07:25	08:42	06:14	07:34
08:36	09:48	06:38(только по раб)	07:50
09:37	10:55	07:53	09:11
10:49	12:09	08:56	10:10
12:04(только по вых)	13:24	10:11	11:25

13:36	14:55	11:16	12:38
14:42	16:03	12:32(только по вых)	13:52
16:15	17:30	14:05	15:17
17:35	18:48	15:10	16:25
18:35	19:52	16:20	17:41
19:15 (только по раб)	20:15	17:48	19:08
20:21	21:40	19:03	20:12
21:39	22:57	20:17	21:35
22:38	23:57	22:13	23:32

Местный автобус № 25

Встречает практически все (кроме трех последних) прибывающие на ст. Звенигород электрички и ожидает, пока приехавшие на них пассажиры не сядут в автобус. Тем не менее, к автобусу надо двигаться быстро, чтобы случайно не упустить его. Время в пути до остановки «Дом отдыха «Ершово» – около 15 минут.

Остановки автобуса № 25

Ст. Звенигород, Санаторий «Звенигород», Игнатьево, Игнатьево-магазин, Кинотеатр (обратно — Бани), (обратно — Украинская ул.), Магазин № 3, Горбольница, Квартал имени Маяковского, Автосервис, Турбаза «Звенигород», Амбулатория, Ершово, Дом отдыха «Ершово», По требованию, Фуньково, Городок Фуньково

Расписание движения автобуса № 25 от Дома отдыха «Ершово» к станции Звенигород:

04:51 05:43 06:12 07:03 07:15 08:13 09:17 09:20 09:40
10:35 11:32 12:44 12:52 13:10 14:05 14:17 15:30 16:38
16:40 17:00 18:14 18:31 19:25 20:28 22:13 22:15

- от **Белорусского вокзала** на электричке до станции «**Голицыно**» (ориентировочное время 50 минут). Станция «Голицыно» расположена между ст. «Звенигород» и Москвой. До и через ст. Голицыно следуют и другие поезда, помимо тех, что идут до Звенигорода. От станции Голицыно до остановки «Ершово» в Звенигороде с **6.35 до 21.30 часов** ходит **маршрутное такси № 22**. (время в пути 40 минут). Интервал движения – 15-20 минут. *Если предупредить водителя, то он довезет до остановки «Дом отдыха Ершово».* Расстояние между остановками «Ершово» и «Дом отдыха Ершово» – около 600 метров.
- от метро «**Строгино**» с **6.55 до 22.10 часов** ходит автобус **№881** до остановки «**Квартал Маяковского**» (время в пути 50 минут), интервал движения – 15-40 минут, далее (**до 21.59**) пересадка на автобус **№ 25** или маршрутное такси **№22** до остановки «**Дом отдыха Ершово**».

- от метро «Кунцево» с 7.00 до 22 часов ходит автобус № 452 до остановки «Квартал Маяковского» (время в пути 1 час 20 минут), интервал движения – 15-40 минут, далее (до 21.59) пересадка на автобус №25 или маршрутное такси №22 до остановки «Дом отдыха Ершово»

На автомобиле

от МКАД по Ново-Рижскому шоссе до пересечения с малой московской областной кольцевой дорогой А107, на развязке свернуть по указателю в сторону г. Звенигород. Следовать до г. Звенигород, на втором светофоре повернуть направо, далее по дороге через посёлок Супонево двигаться до Д/О Ершово.

Культурная программа

Вечер встречи

Фуршет в связи с началом работы Конференции состоится в воскресенье 20 сентября в 20.30 часов в помещении столовой пансионата.

Экскурсия

В среду 23 сентября с 9.30 до 14.00 часов состоится экскурсия. Запись на экскурсию производится до 12 часов утра вторника 22 сентября.

Вечер русского романа

Состоится в среду 23 сентября в 21.00 час в музыкальном салоне Культурно-спортивного центра.

Банкет

Товарищеский ужин состоится в четверг 24 сентября в 19.30 часов в столовой пансионата. Стоимость банкета с учетом льгот и дотаций составляет для участников 400 руб. Просьба записаться для участия в банкете не позднее вторника 22 сентября.

Спортивные и оздоровительные мероприятия

В пансионате имеются спортивный и теннисный залы, библиотека, бассейн, сауны, баня, медицинское обслуживание и пр.

Тематика и формат конференции

В программу конференции включено 388 доклада (в том числе 32 приглашенных) по следующим разделам:

1. **Объемные полупроводники:** электрические и оптические свойства, релаксация носителей заряда, сверхбыстрые явления, экситоны, фононы, фазовые переходы, упорядочение.
2. **Поверхность, пленки, слои:** эпитаксия, атомная и электронная структура поверхности, адсорбция и поверхностные реакции, процессы формирования (самоорганизации) нанокластеров, СТМ и АСМ, оптическая микроскопия ближнего поля.
3. **Гетероструктуры и сверхрешетки:** структурные и оптические свойства, электронный транспорт, микрорезонаторы.
4. **Двумерные системы:** структурные, электронные, магнитные и оптические свойства, туннелирование, локализация, фононы, плазмоны, квантовый эффект Холла, корреляционные эффекты.
5. **Одномерные и нульмерные системы:** энергетический спектр, электронный транспорт, оптические свойства, локализация.
6. **Спиновые явления, спинтроника, наномagnetизм.**
7. **Примеси и дефекты (объемные полупроводники и квантово-размерные структуры):** примеси с мелкими и глубокими уровнями, магнитные примеси, структурные дефекты, неупорядоченные полупроводники.
8. **Высокочастотные явления в полупроводниках (СВЧ и терагерцовый диапазон).**
9. **Органические полупроводники, молекулярные системы.**
10. **Углеродные наноматериалы.**
11. **Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанопотоника.**
12. **Полупроводниковые приборы и устройства:** технология, методы исследования, наноприборы.
13. **Наномеханика.**
14. **Топологические изоляторы.**

Коды докладов

Всем докладам, включенным в Программу конференции, присвоены коды, которые приведены перед их названиями.

Формат кода для устных докладов: <День недели> <Зал> <Номер заседания> <Порядковый номер доклада> <статус доклада: пл – пленарный, п – приглашенный, у – устный>.

Формат кода стендового сообщения: <День недели> <Номер тематики> <Номер стенда> <с — стенд>.

Эти же коды использованы в сборнике Тезисов докладов Конференции.

Пленарные и тематические заседания

В соответствии с Программой конференции (см. ниже) пленарные заседания пройдут в Большом киноконцертном зале Культурно-спортивного центра. Здесь же будут проходить тематические секции в течение всех пяти дней работы Конференции. Ряд тематических секций будет идти параллельно в Малом зале центра.

Приглашенным докладчикам выделяется для выступления 35 минут на пленарных заседаниях, 25 минут на секционных заседаниях и по 5 минут на дискуссию. Для устных докладов – 17 минут для выступления и 3 минуты на дискуссию.

Докладчикам будет предоставлено необходимое оборудование для мультимедийной демонстрации презентаций. Докладчикам советуем заблаговременно обратиться в оргкомитет и проверить качество демонстрации своих материалов.

Стендовые сессии

Три двухчасовые стендовые сессии будут проведены вечером перед ужином **в понедельник** 21 сентября (тематические разделы **2, 3, 14**), **во вторник** 22 сентября (тематические разделы **1, 4, 5, 8, 10**) и **в среду** 23 сентября (тематические разделы **6, 7, 9, 11, 12, 13**) в фойе Культурно-спортивного центра. Докладчикам будут предоставлены стенды площадью 1х1 кв.м и клейкая лента для прикрепления докладов к стендам. Стенды будут пронумерованы (номер стенда содержится в коде доклада).

Интернет

Участникам Конференции будет предоставлена возможность пользования Интернетом.

Премии

Программным комитетом конференции учреждены премии за лучшие доклады молодых ученых. Подведение итогов конкурса и вручение премий с участием представителей ФИОП РОСНАНО пройдет на Закрытии конференции.

Расписание работы конференции

Воскресенье, 20 сентября

15:00 – 22:00	<i>Регистрация</i>
19:00 – 20:00	<i>Ужин</i>
20:30 – 22:00	<i>Вечер встречи</i>

Понедельник, 21 сентября

08:30 – 09:30	<i>Завтрак</i>	
08:30 – 12:00	<i>Регистрация</i>	
11:40 – 13:30	Зал А (Большой зал) Открытие Конференции Пленарное заседание I	
13:30 – 14:30	<i>Обед</i>	
14:30 – 17:40	Зал А (Большой зал) Гетероструктуры и сверхрешетки I	Зал Б (Малый зал) Поверхность, пленки, слои I
17:40 – 18:00	<i>Перерыв, кофе</i>	
18:00 – 20:00	Стендовая сессия I	
20:00 – 21:00	<i>Ужин</i>	
21:00	<i>Кинофильм</i>	

Вторник, 22 сентября

08:30 – 09:30	<i>Завтрак</i>	
	Зал А (Большой зал)	Зал Б (Малый зал)
09:30 – 11:50	Гетероструктуры и сверхрешетки II	Объемные полупроводники
11:50 – 12:10	<i>Перерыв, кофе</i>	
12:10 – 14:00	Двумерные системы I	Углеродные наноматериалы
14:00 – 15:00	<i>Обед</i>	
15:00 – 17:40	Двумерные системы II	Одномерные и нульмерные системы системы I
17:40 – 18:00	<i>Перерыв, кофе</i>	
18:00 – 20:00	Стендовая сессия II	
20:00 – 21:00	<i>Ужин</i>	

Среда, 23 сентября

08:30 – 09:30	<i>Завтрак</i>	
09:30 – 14:00	<i>Экскурсия</i>	
14:00 – 15:00	<i>Обед</i>	
	Зал А (Большой зал)	Зал Б (Малый зал)
15:00 – 17:40	Двумерные системы III	Полупроводниковые приборы и устройства I
17:40 – 18:00	<i>Перерыв, кофе</i>	
18:00 – 20:00	Стендовая сессия III	
20:00 – 21:00	<i>Ужин</i>	
21:00	<i>Концерт</i>	

Четверг, 24 сентября

08:30 – 09:30	<i>Завтрак</i>	
	Зал А (Большой зал)	Зал Б (Малый зал)
09:30 – 10:30	Гетероструктуры и сверхрешетки III	Одномерные и нульмерные системы II
10:30 – 11:30	Топологические изоляторы I	Полупроводниковые приборы и устройства II
11:30 – 11:50	<i>Перерыв, кофе</i>	
11:50 – 14:10	Топологические изоляторы II	Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанофотоника
14:10 – 15:10	<i>Обед</i>	
15:10–16:40	Спиновые явления, спинтроника, наномagnetизм I	Поверхность, пленки, слои II
16:40–17:00	<i>Перерыв, кофе</i>	
17:00–18:30	Наномеханика	Органические полупроводники, молекулярные системы
	Примеси и дефекты	
19:30–23:00	<i>Товарищеский ужин</i>	

Пятница, 25 сентября

08:30 – 09:30	<i>Завтрак</i>	
	Зал А (Большой зал)	Зал Б (Малый зал)
09:30 – 12:00	Спиновые явления, спинтроника, наномagnetизм II	Высокочастотные явления в полупроводниках
12:00 – 12:20	<i>Перерыв, кофе</i>	
12:20 – 14:10	Зал А (Большой зал) Пленарное заседание II Заккрытие конференции	
14:10 – 15:10	<i>Обед</i>	
16:00 – 17:00	<i>Отъезд из пансионата</i>	

Научная программа

Понедельник, 21 сентября

Открытие конференции

Пленарное заседание

Большой зал • 11:40–13:30

- ***Е. Л. Ивченко***
Вступительное слово

Пн А0-1пл *П. С. Копьев*
Нитриды в мире и в России (40 мин)

Пн А0-2пл *В. М. Пудалов*
Термодинамика и магнитопроводимость коррелированной
2D электронной системы (40 мин)

Гетероструктуры и сверхрешетки I

Большой зал • 14:30–17:40

Председатель: **В. Б. Тимофеев**

Пн А 1-1п *С. С. Гаврилов, Н. А. Гиппиус, А. А. Деменев,*
В. Д. Кулаковский
Нестационарные и переходные состояния сильнонеравно-
весного конденсата экситонных поляритонов (30 мин)

Пн А 1-2п *А. С. Журавлев*
Конденсация спин-циклотронных экситонов в
GaAs/AlGaAs гетероструктурах (30 мин)

Пн А 1-3у *А. В. Черненко, Ю. Фишер, С. Бродбек, И. Ледерер,*
А. Рахими-Иман, М. Амтор, В. Д. Кулаковский, М. Камп,
М. Дурнев, К. Шнайдер, А. В. Кавокин, С. Хёфлинг
Конденсат поляритонов в магнитном поле: изменение зна-
ка g-фактора и скачок диамагнитной восприимчивости
(20 мин)

Пн А 1-4у *Т. С. Шамирзаев, J. Debus, М. М. Глазов, Е. Л. Ивченко,*
Д. Р. Яковлев, М. Вауер
Динамика рекомбинации экситонов в гетероструктурах с
монослойными квантовыми ямами GaAs/AlAs и InAs/AlAs
в сильных магнитных полях (20 мин)

Перерыв 10 мин.

Председатель: **С. Г. Тиходеев**

- Пн А 1-5у** *И. Я. Герловин, И. И. Игнатъев, И. А. Ловцюс, В. В. Петров, А. В. Трифонов*
Биения квантово-размерных экситонных состояний в InGaAs/GaAs гетероструктуре (20 мин)
- Пн А 1-6у** *Р. В. Чербунин, Н. Е. Коптева, А. В. Михайлов*
Гигантское керровское вращение света в структурах с микрорезонаторами (20 мин)
- Пн А 1-7у** *В. В. Белых, М. В. Кочиев*
Нагрев экситонной системы вследствие излучательной рекомбинации экситонов и биэкситонов в квантовых ямах GaAs/AlGaAs (20 мин)
- Пн А 1-8у** *А. Ю. Маслов, О. В. Прошина*
Электрон-фононное взаимодействие в анизотропных квантовых ямах (20 мин)

Поверхность, пленки, слой I

Малый зал • 14:30–17:40

Председатель: **А. В. Латышев**

- Пн Б 1-1п** *А. Г. Журавлев, А. С. Романов, А. Г. Паулиш, Г. Э. Шайблер, В. Л. Альперович*
Фотоэмиссия из GaAs с неравновесными слоями цезия (30 мин)
- Пн Б 1-2п** *М. О. Нестоклон*
Эффекты атомарной структуры интерфейсов в полупроводниковых наносистемах (30 мин)
- Пн Б 1-3у** *А. Б. Одобеско, А. А. Майзлах, С. В. Зайцев-Зотов*
Влияние динамической Кулоновской блокады на туннельные характеристики поверхности Si(111)-7x7 (20 мин)
- Пн Б 1-4у** *А. Н. Чайка, О. В. Молодцова, С. Бабенков, А. Захаров, Yuran Niu, Д. Марченко, J. Sánchez-Barriga, P. Mandal, А. Варыхалов, А. Locatelli, А. Sala, Т. Onur Mentés, В. Ю. Аристов*
Атомная и электронная структура графена на поверхности кубического карбида кремния SiC(001) (20 мин)

Перерыв 10 мин.

Председатель: **В. М. Пудалов**

- Пн Б 1-5у** *А. А. Веденеев, К. Н. Ельцов*
Структурный переход $4 \times 2 / 8 \times 2 \rightarrow n \times 6$ на поверхности GaAs(001) при температурах 350-500 °С (20 мин)
- Пн Б 1-6у** *В. В. Бакин, К. В. Торонецкий, Г. Э. Шайблер, А. С. Терехов*
Механизмы Cs-индуцированной хемосорбции кислорода на поверхности p-GaAs(Cs,O) (20 мин)
- Пн Б 1-7у** *В. В. Бакин, Д. В. Горшков, С. А. Рожков, С. Н. Косолобов, Г. Э. Шайблер, А. С. Терехов*
Неупругое рассеяние фотоэлектронов на границе раздела $p^+ - \text{GaAs}(\text{Cs},\text{O}) - \text{вакуум}$ (20 мин)
- Пн Б 1-8у** *Д. В. Грузнев, Л. В. Бондаренко, А. В. Матецкий, А. Ю. Тупчая, С. В. Еремеев, J.-P. Chou, C.-R. Hsing, C.-M. Wei, А. В. Зотов, А. А. Саранин*
Управление структурой спин-расщепленных электронных состояний в двумерных сплавах на поверхности полупроводников (20 мин)

Стендовая сессия

●18:00–20:00

Вторник, 22 сентября

Гетероструктуры и сверхрешетки II

Большой зал ●9:30–11:50

Председатель: **В. И. Гавриленко**

- Вт А 1-1п** *А. Ф. Цацульников, В. В. Лундин, А. Е. Николаев, А. В. Сахаров, Н. Черкашин, В. М. Устинов*
Стимулированная фазовая сепарация в InGaAlN гетероструктурах (30 мин)
- Вт А 1-2п** *В. В. Бельков, М. М. Глазов, Л. Е. Голуб, М. А. Семина, З. Д. Квон, Д. А. Козлов, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий, С. Zoth, С. Д. Ганичев*
Квантовые осцилляции фототока в квантовых ямах на основе теллурида ртути (30 мин)

- Вт А 1-3у** *И. В. Алтухов, М. С. Казан, С. К. Папроцкий, А. Д. Буравлев, А. П. Васильев, Н. Д. Ильинская, А. А. Усикова, В. М. Устинов*
Влияние ТГц резонатора на туннельную проводимость короткопериодных сверхрешеток (20 мин)
- Вт А 1-4у** *Ю. Н. Ханин, Е. Е. Вдовин, М. Непіні*
Осцилляции фотопроводимости в p-i-n GaAs/AlAs гетероструктурах с квантовыми точками (20 мин)
- Вт А 1-5у** *М. А. Пятаев, А. В. Шорохов, Д. С. Приймак, Н. Н. Хвастунов, К. Н. Алексеев*
Механизм усиления терагерцового излучения на отрицательных электронных массах в полупроводниковой сверхрешетке (20 мин)
- Вт А 1-6у** *М. П. Теленков, Ю. А. Митягин, А. А. Куцевол, В. В. Агафонов*
Межподзонная инверсия населенностей и вынужденные излучательные переходы терагерцового диапазона в системе уровней Ландау в резонансно-туннельных структурах из квантовых ям (20 мин)

Объемные полупроводники

Малый зал ●9:30–11:50

Председатель: **А. А. Горбацевич**

- Вт Б 1-1п** *П. П. Васильев*
Квантовый фазовый переход в процессе сверхизлучения в полупроводниках при комнатной температуре (30 мин)
- Вт Б 1-2п** *Р. Х. Жукавин, В. Н. Шастин, С. Г. Павлов, Н.-W. Hübers*
Механизмы стимулированного излучения в кремнии с мелкими примесными центрами: вынужденное комбинационное рассеяние и инверсия населенности (30 мин)
- Вт Б 1-3у** *С. В. Мутилин, А. Ф. Булдыгин, Л. В. Яковкина, В. Я. Принц*
Фазовый переход полупроводник-металл в диоксиде ванадия: обзор работ и результаты воздействия импульсного СВЧ поля (20 мин)

- Вт Б 1-4у** *В. С. Багаев, Ю. В. Клевков, В. С. Кривобок, С. Н. Николаев, А. А. Пручкина*
Излучение изолированных систем типа «точечный дефект–дислокация» в высокочистых поликристаллах CdTe (20 мин)
- Вт Б 1-5у** *А. И. Вейнгер, А. Г. Забродский, П. В. Семенихин, Т. В. Тиснек, С. И. Голощапов*
Спиновое упорядочение и низкотемпературный транспорт в Ge:As вблизи фазового перехода изолятор – металл (20 мин)
- Вт Б 1-6у** *М. А. Семина, М. М. Глазов, J. Thewes, J. Heckotter, T. Kazimierczuk, M. Aßmann, D. Frohlich, M. Bayer*
Тонкая структура F-экситонов в заиси меди (20 мин)

Двумерные системы I

Большой зал • 12:10–14:00

Председатель: **Р. А. Сурис**

- Вт А 2-1п** *М. В. Боев, В. М. Ковалев, А. В. Чаплик*
Акустоэкситонное взаимодействие в бозе-эйнштейновском конденсате непрямых дипольных экситонов (30 мин)
- Вт А 2-2у** *А. В. Горбунов, Л. В. Кулик, А. С. Журавлев, В. Б. Тимофеев, И. В. Кукушкин*
Сверхмедленная спиновая релаксация в системе двумерных электронов (20 мин)
- Вт А 2-3у** *В. К. Калевич, М. М. Афанасьев, В.А. Лукошкин, Д. Д. Солнышков, G. Malpuech, К. В. Кавокин, S. I. Tsintzos, Z. Hatzopoulos, P. G. Savvidis, А. В. Кавокин*
Структурирование конденсата экситонных поляритонов в цилиндрических пилларах с микрорезонатором (20 мин)
- Вт А 2-4у** *Т. М. Бурбаев, М. А. Акмаев, Д. С. Козырев, В. С. Кривобок, С. Н. Николаев, Н. Н. Сибельдин, В. В. Ушаков, В. А. Цветков, А. В. Новиков, Д. Н. Лобанов*
Электронно-дырочная жидкость в Si/Ge гетероструктурах II рода (20 мин)
- Вт А 2-5у** *В. В. Еналдиев, В. А. Волков*
Поверхностные состояния в висмутовой нанопроволоке (20 мин)

Углеродные наноматериалы

Малый зал • 12:10–14:00

Председатель: **Г. М. Миньков**

- Вт Б 2-1п** *А. А. Дубинов, В. И. Рыжий, В. Я. Алешкин, М. В. Рыжий, Т. Otsuji*
Усиление терагерцового излучения при туннелировании электронов между слоями графена (30 мин)
- Вт Б 2-2у** *Е. Е. Вдовин, М. Т. Greenaway, А. Mishchenko, К. S. Novoselov, Т.М. Fromhold, Ю. Н. Ханин, L. Eaves*
Спектроскопия уровней Ландау при туннелировании в структурах графен/нитрид бора/графен (20 мин)
- Вт Б 2-3у** *Ю. Е. Лозовик, А. Д. Заболотский, А. А. Соколик*
Квантовая емкость и скорость Ферми электронного газа в графене: влияние многочастичных эффектов (20 мин)
- Вт Б 2-4у** *С. А. Тарасенко, Л. Е. Голуб, Е. Л. Ивченко*
Долинные оптические и фотогальванические эффекты в двумерных кристаллах (20 мин)
- Вт Б 2-5у** *Л. С. Брагинский, М. В. Энтин*
Междолинное рассеяние электронов заряженными примесями в графене (20 мин)

Двумерные системы II

Большой зал • 15:00–17:40

Председатель: **А. В. Чаплик**

- Вт А 3-1п** *А. Б. Ваньков, И. В. Кукушкин, В. В. Соловьев*
Магнитооптика сильнокоррелированных двумерных электронных систем в структурах ZnO/MgZnO (30 мин)
- Вт А 3-2п** *В. М. Муравьев, П. А. Гусихин, И. В. Кукушкин*
Новый тип плазменных возбуждений в двумерной электронной системе с верхним затвором (30 мин)
- Вт А 3-3у** *С. И. Дорожкин, К. von Klitzing, J. H. Smet*
Нерегулярные перевороты электрического поля в доменной структуре, возникающей в неравновесных двумерных электронных системах под микроволновым облучением (20 мин)

- Вт А 3-4у** *А. А. Заболотных, В. А. Волков*
Спектр краевых плазмонов при учёте электромагнитного запаздывания (20 мин)
- Вт А 3-5у** *И. В. Андреев, В. М. Муравьев, В. Н. Белянин, И. В. Кукушкин*
Радиационный и релаксационный вклад в ширину линии магнитоплазменного резонанса в двумерных электронных системах (20 мин)
- Вт А 3-6у** *А. Р. Хисамеева, В. Н. Белянин, П. А. Гусихин, В. М. Муравьев, И. В. Кукушкин*
Плазменные возбуждения в двумерной системе тяжелых анизотропных фермионов (20 мин)
- Вт А 3-7у** *А. В. Щепетильников, Ю. А. Нефёдов, И. В. Кукушкин*
Изучение спиновых свойств двумерных систем с тяжелыми электронами посредством методики ЭПР (20 мин)

Одномерные и нульмерные системы I

Малый зал • 15:00–17:30

Председатель: **С. В. Зайцев-Зотов**

- Вт Б 3-1п** *А. В. Родина, Ал. Л. Эфрос*
Радиационная рекомбинация темного экситона в коллоидных нанокристаллах (30 мин)
- Вт Б 3-2п** *А. Г. Милёхин, Л. Л. Свешникова, Т. А. Дуда, Е. Е. Родякина, Н. А. Ерюков, V. M. Dzhagan, E. Sheremet, O. D. Gordan, A. B. Латышев, D. R. T. Zahn*
Гигантское комбинационное рассеяние света полупроводниковыми нанокристаллами на плазмонных структурах (30 мин)
- Вт Б 3-3п** *А. А. Шевырин, А. Г. Погосов, М. В. Буданцев*
Аномалии электронного транспорта в подвешенных полупроводниковых наноструктурах (30 мин)
- Вт Б 3-4у** *А. М. Смирнов, М. В. Козлова, В. С. Днепровский*
Нелинейные оптические процессы при самодифракции трех лазерных лучей в коллоидных квантовых точках CdSe/ZnS (20 мин)

Вт Б 3-5у *С. Г.Зыбцев, В. Я. Покровский*
Структурная перестройка волны зарядовой плотности при одноосной деформации и аномалии механических свойств квазиодномерных проводников (20 мин)

Вт Б 3-6у *С. Г. Зыбцев, В. Я. Покровский, А. П. Орлов*
NbS₃ – уникальный квазиодномерный полупроводник с тремя пайерлсовскими переходами (20 мин)

Стендовая сессия II ●18:00–20:00

Среда, 23 сентября

Двумерные системы III

Большой зал ●15:00–17:40

Председатель: **В. А. Волков**

Ср А 1-1п *А. А. Быков*
Нелинейный электронный транспорт в гетероструктурах GaAs/AlAs при больших факторах заполнения (30 мин)

Ср А 1-2п *Д. А. Козлов, З. Д. Квон, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий*
Квантовый эффект Холла в системе дираковских фермионов на основе HgTe (30 мин)

Ср А 1-3у *Г. М. Миньков, А. В. Германенко, А. А. Шерстобитов, О. Э. Рут, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий*
Гигантское нарушение электрон-дырочной симметрии спин-орбитального расщепления дираковских фермионов в HgTe ямах (20 мин)

Ср А 1-4у *З. Д. Квон, Т. Herrman, Д. А. Козлов, С. Н. Данилов, В. В. Бельков, В. Jentsch, Р. Olbrich, С. Д. Ганичев, D. Weiss*
Осцилляции магнитопроводимости двумерного электронного газа, индуцированные мощным терагерцовым излучением (20 мин)

Ср А 1-5у *А. А. Шерстобитов, Г. М. Миньков, А. В. Германенко, О. Е. Рут, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий*
Квантовая емкость двумерных систем HgTe при толщинах, близких к критической (20 мин)

- Ср А 1-6у** *И. Л. Дричко, И. Ю. Смирнов, А. В. Суслов, L. N. Pfeiffer, K. W. West, Ю. М. Гальперин*
Вигнеровский кристалл в режиме дробного квантового эффекта Холла в окрестности $\nu=1/5$. Акустические методы исследования (20 мин)
- Ср А 1-7у** *А. В. Германенко, Г. М. Миньков, О. Э. Рут, А. А. Шерстобитов, Н. Н. Михайлов, С.А. Дворецкий*
Слабая антилокализация в квантовых ямах HgTe вблизи дираковской точки (20 мин)

Полупроводниковые приборы и устройства I

Малый зал • 15:00–17:40

Председатель: **А. С. Терехов**

- Ср Б 1-1п** *С. В. Морозов, В. В. Румянцев, А. В. Антонов, А. А. Дубинов, В. Я. Алёшкин, А. М. Кадыков, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий и В. И. Гавриленко*
Структуры HgCdTe для лазеров дальнего ИК диапазона (30 мин)
- Ср Б 1-2п** *В. В. Васильев, В. С. Варавин, С. А. Дворецкий, В. Д. Кузьмин, Н. Н. Михайлов, В. Г. Ремесник, И. В. Сабина, Г. Ю. Сидоров, Ю. Г. Сидоров, М. В. Якушев, А. В. Латышев*
Гетероэпитаксиальные наноструктуры HgCdTe для фотоприемников и лазерных излучателей (30 мин)
- Ср Б 1-3у** *А. А. Гузев, В. М. Базовкин, А. П. Ковчавцев, А. В. Царенко, З. В. Панова, М. В. Якушев, Д. В. Марин, В. С. Варавин, В. В. Васильев, С. А. Дворецкий, И. В. Сабина, Ю. Г. Сидоров, Г. Ю. Сидоров*
CdHgTe p⁺/n структуры выращиваемые МЛЭ на подложках Si(310) для тепловизоров работающих при повышенных температурах (20 мин)
- Ср Б 1-4у** *К. С. Журавлев, А. К. Бакаров, Д. В. Гуляев, Д. Ю. Протасов, А. И. Торопов, В. М. Лукашин, В. Г. Лапин, А. Б. Пашковский*
Статус и перспективы мощных DA-pHEMT СВЧ-транзисторов (20 мин)

- Ср Б 1-5у** *Д. Г. Есаев, А. П. Савченко, В. А. Фатеев, И. В. Марчишин, М. А. Демьяненко, А. И. Торопов, А. К. Калагин, Н. А. Валишева, Н. Р. Вицина*
Матричные фотоприемники на основе многослойных структур GaAs/AlGaAs с квантовыми ямами форматом 384x288 и 640x512 (20 мин)
- Ср Б 1-6у** *С. В. Гронин, С. В. Сорокин, И. В. Седова, Г. В. Климко, А. А. Торопов, К. Г. Беляев, С. Рувимов, П. С. Копьев, Е. В. Луценко, А. Г. Войнилович, Г. П. Яблонский, С. В. Иванов*
Низкопороговые лазеры желто-оранжевого диапазона на основе гетероструктур с квантовыми точками CdSe/ZnCdSe, выращенных методом молекулярно-пучковой эпитаксии (20 мин)
- Ср Б 1-7у** *Ю. П. Яковлев, А. А. Леонидов, В. В. Шерстнев, Е. А. Гребенищикова, Н. Д. Ильинская, О. Ю. Серебренникова, R. Teissier, А. Н. Баранов*
Синхронизация мод в лазере со связанными дисковыми резонаторами (20 мин)

Стендовая сессия III

●18:00–20:00

Четверг, 24 сентября

Гетероструктуры и сверхрешетки III

Большой зал ●9:30–10:30

Председатель: **В. Я. Алешкин**

- Чт А 1-1у** *О. А. Ткаченко, В. А. Ткаченко, И. С. Терехов, О. П. Сушков*
Электростатическая сверхрешетка как искусственный графен: критический беспорядок и электронная экранировка (20 мин)
- Чт А 1-2у** *Е. А. Емельянов, А. В. Васев, М. А. Путьто, И. Б. Чистохин, В. В. Румянцев, С. В. Морозов, Б. Р. Семягин, А. П. Василенко, А. К. Гутаковский, В. В. Преображенский*
Молекулярно-лучевая эпитаксия сверхрешеток GaSb/InAs: влияние температуры роста на свойства структур (20 мин)

- Чт А 1-3у** *М. М. Соболев, М. С. Буяло, В. Н. Неведомский, Ю. М. Задиранов, Р. В. Золотарева, Е. Л. Портной*
Прямое наблюдение полярона в сверхрешетке квантовых точек In(Ga)As/GaAs (20 мин)

Одномерные и нульмерные системы II

Малый зал • 9:30–10:30

Председатель: **М. М. Глазов**

- Чт Б 1-1у** *В. П. Кочерешко, А. В. Платонов, В. Н. Кац, P Savvidis, A. V. Kavokin, L. Besombes, H. Mariette*
Бозе конденсация экситонных поляритонов в микрорезонаторах индуцированная магнитным полем (20 мин)
- Чт Б 1-2у** *В. А. Зиновьев, А. В. Дзуреченский, Ж. В. Смагина, Р. А. Кучинская, С. А. Рудин, А. В. Мудрый*
Разреженные массивы кольцевых молекул из квантовых точек (20 мин)
- Чт Б 1-3у** *В. А. Гайслер, А. В. Гайслер, А. И. Дербезов*
Неклассические излучатели на основе квантовых точек (20 мин)

Топологические изоляторы I

Большой зал • 10:30–11:30

Председатель: **А. А. Саранин**

- Чт А 2-1п** *С. И. Веденеев*
Квантовые осцилляции в сильных магнитных полях, фаза Берри и сверхпроводимость в 3D топологических изоляторах $\text{Bi}_2\text{Cu}_x\text{Se}_3$ (30 мин)
- Чт А 2-2п** *А. Н. Поддубный*
Топологические состояния фотонов в наноструктурах (30 мин)

Полупроводниковые приборы и устройства II

Малый зал • 10:30–11:30

Председатель: **Ю. П. Яковлев**

- Чт Б 2-1у** *И. И. Засавицкий, М. Д. Кузьмичев, А. Н. Зубов, А. А. Мармалюк, М. А. Ладугин, А. А. Падалица, А. В. Лобинцов, Ю. В. Курнявко, С. М. Сапожников, Т. А. Багаев, А. Ю. Андреев, В. А. Симаков, С. С. Зарубин*
Квантовый каскадный лазер, излучающий в ИК области спектра около 10 мкм (20 мин)
- Чт Б 2-2у** *В. Е. Земляков, В. И. Егоркин, Т. В. Малин, В. Г. Мансуров, К. С. Журавлев*
Нормально закрытый AlN-GaN СВЧ-транзистор (20 мин)
- Чт Б 2-3у** *В. И. Брылевский, А. В. Рожков, И. А. Смирнова, П. Б. Родин, И. В. Грехов*
Новый механизм генерации электронно-дырочной плазмы в GaAs диодах после пикосекундного лавинного переключения (20 мин)

Топологические изоляторы II

Большой зал • 11:50–14:10

Председатель: **А. В. Двореченский**

- Чт А 3-1у** *А. А. Капустин, В. С. Столяров, С. И. Божко, Д. Н. Борисенко, Н. Н. Колесников*
Транспортные и туннельные измерения $\text{Bi}_2\text{Te}_2\text{Se}$: свойства объемных и квазидвумерных носителей заряда (20 мин)
- Чт А 3-2у** *В. А. Сабликов, А. А. Суханов*
Квантовые примесные состояния в 2D топологических изоляторах (20 мин)
- Чт А 3-3у** *Д. А. Козлов, З. Д. Квон, D. Weiss, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий*
Магнитоемкостная спектроскопия трехмерного топологического изолятора на основе HgTe (20 мин)
- Чт А 3-4у** *В. И. Гавриленко, М. С. Жолудев, А. В. Иконников, К. Е. Спириин, Л. С. Бовкун, M. Orlita, F. Terpe, W. Knapp, С. А. Дворецкий, Н. Н. Михайлов*
О структуре валентной зоны квантовых ям HgTe/CdHgTe (20 мин)

- Чт А 3-5у** *С. Г. Егорова, В. И. Черничкин, Л. И. Рябова, Е. П. Скипетров, Л. В. Яшина, С. Н. Данилов, С. Д. Ганичев, Д. Р. Хохлов*
 Детектирование протяженных поверхностных состояний в кристаллических топологических изоляторах $Pb_{1-x}Sn_xSe$ с помощью лазерного терагерцового излучения (20 мин)
- Чт А 3-6у** *Л. Е. Голуб, В. В. Бельков, Н. Plank, S. D. Ganichev*
 Нелинейный транспорт в топологических изоляторах (20 мин)
- Чт А 3-7у** *А. В. Галеева, С. Г. Егорова, М. Е. Тамм, Л. В. Яшина, С. Н. Данилов, Л. И. Рябова, Д. Р. Хохлов*
 Фотоэлектромагнитный эффект в топологических изоляторах $(Bi_{1-x}In_x)_2Se_3$ в окрестности бесщелевого состояния (20 мин)

Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанофотоника

Малый зал • 11:50–14:10

Председатель: **П. С. Копьев**

- Чт Б 3-1п** *А. Е. Жуков, М. В. Максимов, Н. В. Крыжановская*
 Микролазеры сверхмалого диаметра с квантовыми точками (30 мин)
- Чт Б 3-2п** *А. А. Максимов, И. И. Тартаковский, Е. В. Филатов, В. Д. Кулаковский, С. Schneider, S. Höfling, M. Kamp*
 Циркулярно поляризованные моды в планарном хиральном фотонном кристалле на основе GaAs (30 мин)
- Чт Б 3-3у** *С. В. Лобанов, Н. А. Гиппиус, В. Д. Кулаковский, С. Г. Тиходеев*
 Кирально-модулированные полупроводниковые структуры для источников циркулярно-поляризованного света (20 мин)
- Чт Б 3-4у** *А. А. Горбацевич, В. В. Канаев*
 Метарезонансы в структурах металл-диэлектрик (20 мин)
- Чт Б 3-5у** *В. С. Горелик, В. В. Канаев*
 Усиление электромагнитного поля в конечной слоистой периодической структуре (20 мин)

- Чт Б 3-6у** *А. А. Федянин*
Нелинейно-оптические явления в полностью диэлектрических метаматериалах (20 мин)

Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм I

Большой зал • 15:10–16:40

Председатель: **Ю. Г. Кусраев**

- Чт А 4-1п** *В. С. Запасский*
Спектроскопия спонтанного магнитного резонанса полупроводниковых структур (30 мин)
- Чт А 4-2у** *Н. С. Аверкиев, Б. А. Аронзон, А. Б. Давыдов, И. В. Крайнов, В. А. Кульбачинский, Л. Н. Овешников, И. В. Рожанский, Е. И. Яковлева*
Ферромагнетизм и аномальный эффект Холла в 2D структуре GaAs/InGaAs/GaAs с отдаленным дельта слоем Mn (20 мин)
- Чт А 4-3у** *Н. С. Аверкиев, М. О. Нестоклон, С. А. Тарасенко*
Слабая локализация и антилокализация в многодолинных наноструктурах (20 мин)
- Чт А 4-4у** *И. В. Рожанский, К. С. Денисов, Н. С. Аверкиев*
Эффекты резонансно-туннельной спиновой поляризации в гетероструктурах (20 мин)

Поверхность, пленки, слой II

Малый зал • 15:10–16:40

Председатель: **И. И. Засавицкий**

- Чт Б 4-1п** *Ж. В. Смагина, В. А. Зиновьев, А. Ф. Зиновьева, Н. П. Степина, А. В. Двуреченский*
Пространственно упорядоченные планарные ансамбли квантовых точек (30 мин)
- Чт Б 4-2у** *О. Е. Терещенко, В. А. Голяшов, С. В. Еремеев, Л. В. Бондаренко, А. Ю. Тупчая, Д. В. Грузнев, А. А. Саранин*
Поиск снятия вырождения Рашбы 2D электронных состояний в системе Bi/InAs(111)A (20 мин)

Чт Б 4-3у *М. В. Лебедев, В. Kaiser, W. Jaegermann*
Синхротронные исследования фотоэлектрохимического разложения воды на границе р-GaInP₂ с водным раствором HCl (20 мин)

Чт Б 4-4у *П. А. Алексеев, М. С. Дунаевский, В. П. Улин, В. Л. Берковиц*
Нитридная химическая пассивация поверхности GaAs нанопроводов (20 мин)

Наномеханика. Примеси и дефекты

Большой зал • 17:00–18:30

Председатель: **Д. Р. Хохлов**

Чт А 5-1п *Е. А. Вopilкин, С. А. Гусев, А. Ю. Климов, В. В. Rogov, Е. В. Скорыходов, И. Ю. Шулешова, В. И. Шашкин*
МЭМС структуры для сенсорных приложений (30 мин)

Чт А 5-2у *А. А. Шевырин, А. Г. Погосов, М. В. Буданцев, А. К. Бакаров, А. И. Торопов, Е. Е. Родякина и А. А. Шкляев*
Возбуждение и детектирование колебаний нанозлектромеханических систем на основе гетероструктур с двумерным электронным газом (20 мин)

Чт А 5-3у *Е. П. Скипетров, О. В. Крулевецкая, Л. А. Скипетрова, Е. И. Слынько, В. Е. Слынько*
Стабилизация уровня Ферми в теллуриде свинца, легированном железом, под давлением (20 мин)

Чт А 5-4у *А. Т. Лончаков, С. Б. Бобин, В. В. Дерюшкин, В. И. Окулов, Т. Е. Говоркова*
Наблюдение проявлений токов спонтанного намагничивания в кристаллах селенида ртути с низкой концентрацией примесей 3d- металлов (20 мин)

Органические полупроводники, молекулярные системы

Малый зал • 17:00–18:30

Председатель: **А. Е. Жуков**

Чт Б 5-1п *А. В. Ненашев, J. O. Oelerich, А. В. Двуреченский, F. Gebhard, С. Д. Барановский*
Транспортная энергия в неупорядоченных органических полупроводниках (30 мин)

- Чт Б 5-2у** *А. Н. Алешин, И. П. Щербаков*
 Наноккомпозитные материалы с повышенной подвижностью на основе неорганических наночастиц, частиц графена, оксида графена встроенных в полимерную матрицу
 (20 мин)
- Чт Б 5-3у** *П. С. Крылов, А. С. Берестенников, А. Н. Алёшин*
 Эффекты низковольтного переключения в композитных плёнках полимер-частицы графена (оксида графена)
 (20 мин)
- Чт Б 5-4у** *Т. Н. Копылова, Е. Н. Тельминов, В. Буртман*
 Создание органического инжекционного лазера – проблемы и достижения
 (20 мин)

Пятница, 25 сентября

Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм II

Большой зал ●9:30–12:00

Председатель: **В. А. Сабликов**

- Пт А 1-1п** *В. Л. Корнев, M. Salewski, И. А. Акимов, В. Ф. Canega, L. Langer, И. В. Калитухо, J. Debus, Р. И. Джиоев, Д. Р. Яковлев, D. Müller, C. Schröder, Н. Hövel, G. Karczewski, M. Wiater, T. Wojtowicz, Ю. Г. Кусраев и M. Bayer*
 Ферромагнитный эффект близости в гибридах ферромагнетик/полупроводниковая квантовая яма
 (30 мин)
- Пт А 1-2у** *L. Langer, С. В. Полтавцев, И. А. Югова, M. Salewski, Д. Р. Яковлев, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut, И. А. Акимов, M. Bayer*
 Фотонное эхо на системе спинов в полупроводнике: доступ к долговременной оптической памяти
 (20 мин)
- Пт А 1-3у** *Е. А. Жуков, Д. Р. Яковлев, Ю. Г. Кусраев, К. В. Кавокин, J. Debus, И. А. Акимов, G. Karczewski, T. Wojtowicz, J. Kossut, M. Bayer*
 Спиновая динамика дырочного магнитного полярона в квантовых ямах (Cd,Mn)Te/(Cd,Mn,Mg)
 (20 мин)
- Пт А 1-4у** *А. В. Ларионов, Л. В. Кулик, С. М. Дикман, И. В. Кукушкин*
 Новый механизм спиновой дефазировки двумерных электронов в Холловском ферромагнетике
 (20 мин)

- Пт А 1-5у** *Й. Дебус, Д. Кудлачик, В. Ф. Санага, Д. Дункер, П. Бон, Й. Раутерт, Д. Браукман, Д. Р. Яковлев, Д. Ройтер, А. Д. Вик, М. Байер*
Исследование электрон-ядерного сверхтонкого взаимодействия в однократно заряженных квантовых точках (In,Ga)As/GaAs методом неупругого рассеяния света с переворотом спина (20 мин)
- Пт А 1-6у** *В. И. Окулов, А. Т. Лончаков, С. Б. Бобин, Т. Е. Говоркова, В. В. Дерюшкин, К. А. Окулова, Е. А. Памятных*
Физическая природа спонтанной спиновой поляризации электронов и термодинамического аномального эффекта Холла в кристаллах с низкой концентрацией примесей 3d – элементов (20 мин)
- Пт А 1-7у** *М. В. Дурнев, L. Bouet, M. Vidal, T. Mano, N. Ha, T. Kuroda, M. M. Глазов, Е. Л. Ивченко, X. Marie, T. Amand, K. Sakoda, G. Wang, B. Urbaszek*
Многочастичные кулоновские комплексы в тригональных квантовых точках GaAs/AlGaAs (20 мин)

Высокочастотные явления в полупроводниках

Малый зал ●9:30–12:00

Председатель: **А. А. Максимов**

- Пт Б 1-1п** *В. В. Попов, Д. В. Фатеев*
Возбуждение фототока нецентросимметричным плазмонным полем в двумерной электронной системе (30 мин)
- Пт Б 1-2у** *О. В. Кибис*
Как подавить обратное рассеяние электронов проводимости? (20 мин)
- Пт Б 1-3у** *С. И. Дорожкин, А. А. Капустин*
Особенности поглощения микроволнового излучения двумерными электронными системами вблизи гармоник циклотронного резонанса (20 мин)
- Пт Б 1-4у** *А. Д. Буравлев, И. А. Мустафин, В. Н. Трухин, J. P. Kakko, T. Nuhtio, H. Lipsanen*
Влияние резонансного поглощения Ми на эффективность генерации терагерцового излучения в полупроводниковых нитевидных нанокристаллах (20 мин)

- Пт Б 1-5у** *К. Журавлев, Т. Малин, В. Мансуров, G. Atmaca, E. Kutlu, P. Narin, B. Sarikavak-Lisesivdin, S. B. Lisesivdin, S. Ardali, E. Tiras*
Энергетическая релаксация горячих электронов в AlGa_N/Ga_N гетероструктурах (20 мин)
- Пт Б 1-6у** *В. А. Гергель, А. В. Верховцева, Н. М. Горшкова, А. П. Зеленый, В. С. Минкин, В. В. Павловский*
Теоретические основы проектирования мультибарьерных гетероструктур для генерации мощного терагерцового излучения (20 мин)
- Пт Б 1-7у** *А. И. Майдыковский, С. Е. Свяховский, Т. В. Мурзина, А. Н. Степанов, С. Б. Бодров, А. А. Мурзанев, Ю. А. Сергеев*
Генерация оптической второй гармоники, индуцированной мощным ТГц излучением в кристаллическом кремнии (20 мин)

Пленарное заседание II Закрытие конференции

Большой зал • 12:20–14:10

- Пт А0-1пл** *В. А. Волков*
Полупроводниковые структуры с дираковскими фермионами (40 мин)
- Д. Р. Хохлов*
Итоги конференции
- Вручение премий за лучшие доклады молодых ученых
 - Закрытие конференции

СТЕНДОВЫЕ ДОКЛАДЫ

Стендовая сессия I **Понедельник** **18:00–20:00**

2. Поверхность, пленки, слои

- Пн 2-1с** *М. В. Дорохин, Д. А. Павлов, А. И. Бобров, Ю. А. Данилов, П. Б. Дёмина, Б. Н. Звонков, А. В. Здоровейцев, А. В. Кудрин, Н. В. Малехонова, Е. И. Малышева*
Эпитаксия ферромагнитных квазикристаллов Mn_xGa_y на поверхности GaAs

- Пн 2-2с** *Ю. Г. Шретер, В. В. Вороненков, В. С. Коготков, М. В. Вирко, Р. И. Горбунов, Ф. Е. Латышев, Н. И. Бочкарёва, А. А. Леонидов, А. С. Зубрилов, Ю. С. Леликов, Ю. Т. Ребане*
Физические основы отделения тонких слоёв от объёмных подложек сверхкороткими лазерными импульсами
- Пн 2-3с** *А. В. Новиков*
Формирование и селективное легирование SiGe низкоразмерных структур и их использование для приборных приложений
- Пн 2-4с** *Е. В. Тихонов, С. В. Лепешкин, Н. Л. Мацко, В. С. Батулин, Ю. А. Успенский, Д. Р. Хохлов*
Первопринципное исследование структуры кремниевых нанокластеров, пассивированных кислородом
- Пн 2-5с** *В. В. Румянцев, С. В. Морозов, А. В. Антонов, К. Е. Кудрявцев, S. Winnerl, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий, М. Helm, В. И. Гавриленко*
Времена жизни неравновесных носителей заряда в узкозонных эпитаксиальных слоях и структурах с квантовыми ямами на основе HgCdTe в условиях сильного возбуждения
- Пн 2-6с** *П. А. Дементьев, М. В. Лебедев, Т. В. Львова, И. В. Седова, А. А. Ситникова, В. А. Соловьев, С. В. Иванов*
Сульфидная пассивация поверхности (100) InSb для молекулярно-пучковой гомоэпитаксии
- Пн 2-7с** *М. С. Дунаевский, П. А. Алексеев, А. А. Донцов, А. М. Монахов, А. Varanov*
Метод измерения светочувствительного сдвига резонансной частоты АСМ-зонда для ближнепольной диагностики светоизлучения полупроводниковых лазеров
- Пн 2-8с** *А. В. Войцеховский, С. Н. Несмелов, С. М. Дзядух, В. В. Васильев, В. С. Варавин, С. А. Дворецкий, Н. Н. Михайлов, М. В. Якушев, Г. Ю. Сидоров*
Свойства границы раздела варизонного МЛЭ Hg_{1-x}Cd_xTe с пассивирующими покрытиями SiO₂/Si₃N₄ и Al₂O₃
- Пн 2-9с** *А. Г. Журавлев, А. С. Романов, В. Л. Альперович*
Влияние адсорбции кислорода на вероятность эмиссии электронов из Cs/GaAs(001) в вакуум

- Пн 2-10с** *М. С. Аксенов, А. Ю. Широков, В. А. Голяшов, С. Е. Хандархаева, А. К. Гутаковский, А. В. Бакулин, С. Е. Кулькова, Н. А. Валишева, О. Е. Терещенко*
Пассивация поверхности InAs фтором при сухом окислении в таунсендовском разряде
- Пн 2-11с** *М. В. Гомоюнова, Г. С. Гребенюк, И. И. Пронин*
Формирование ферромагнитных пленок силицида кобальта Co_3Si на поверхности монокристаллического кремния
- Пн 2-12с** *Н. А. Тулина, А. Н. Россоленко, И. М. Шмытько, Н. Н. Колесников, Д. Н. Борисенко, В. В. Сироткин, И. Ю. Борисенко*
Получение и исследование мезоскопических гетероструктур на основе селенида висмута Bi_2Se_3
- Пн 2-13с** *Е. В. Гущина, О. А. Маслова, J. Alvarez, W. Favre, R. Varache, M. E. Gueunier-Farret, А. С. Гудовских, А. В. Анкудинов, Е. И. Теруков, J. P. Kleider*
Изучение границы $\alpha\text{-Si:H}/\text{c-Si}$ на сколах гетероструктур с помощью сканирующей зондовой микроскопии
- Пн 2-14с** *Т. В. Павлова, Г. М. Жидомиров, К. Н. Ельцов*
Динамика гетерогенной химической реакции хлорирования $\text{Cu}(111)$
- Пн 2-15с** *М. В. Лебедев*
Модификация поверхности полупроводников A^3B^5 посредством зарядового обмена на границе с раствором
- Пн 2-16с** *С. Б. Бодров, А. А. Мурзанев, Ю. А. Мальков, Ю. А. Сергеев, А. Н. Степанов, Д. А. Яшунин*
Исследование генерации второй гармоники оптического излучения с поверхности металла при воздействии мощного терагерцового поля
- Пн 2-17с** *В. Б. Шмагин, К. Е. Кудрявцев, Д. В. Шенгуров, З. Ф. Красильник*
Поглощение Урбаха и флуктуации зонного потенциала в эпитаксиальных слоях Si:Er
- Пн 2-18с** *Д. М. Казанцев, И. О. Ахундов, Н. Л. Шварц, В. Л. Альперович, А. С. Терехов, А. В. Латышев*
Выглаживание и разупорядочение ступенчато-террасированной поверхности GaAs: эксперимент и Монте-Карло моделирование

- Пн 2-19с** *Р. К. Яфаров, В. Я. Шаныгин*
Поверхностный фазовый переход в системе углерод – кремний
- Пн 2-20с** *Б. А. Андреев, П. А. Бушуйкин, Е. В. Демидов, Д. Н. Лобанов, А. В. Новиков, Е. В. Скороходов, П. А. Юнин*
Рост и оптоэлектронные свойства слоёв InN, выращенных методом МПЭ ПА при различных соотношениях потоков 111) элементов III и V групп
- Пн 2-21с** *Б. А. Андреев, О. Б. Гусев, А. Н. Яблонский, А. В. Ершов, Д. А. Грачев, И. Н. Яссиевич, З. Ф. Красильник*
Спектры возбуждения и кинетика люминесценции экситонов, автолокализованных на состояниях поверхностных димеров в нанокристаллах кремния
- Пн 2-22с** *А. Ю. Клоков, А. И. Шарков, Д. Ф. Аминев, В. А. Цветков, Р. А. Хмельницкий*
Зондирование когерентными фононами заглубленных в алмаз графитизированных слоев, созданных имплантацией ионов углерода
- Пн 2-23с** *Д. Е. Свиридов, В. И. Козловский*
Сканирующая микроскопия сопротивления растекания с подсветкой: искажения на топографических изображениях
- Пн 2-24с** *С. А. Денисов, А. В. Нежданов, В. Ю. Чалков, В. Н. Трушин, Д. О. Филатов, Ю. Н. Бузынин, В. Г. Шенгуров*
Гетероэпитаксиальный рост Ge на Si(100) методом горячей проволоки
- Пн 2-25с** *Г. Б. Галиев, Е. А. Климов, А. Н. Клочков, Д. В. Лаврухин, С. С. Пушкарёв*
Структурные и фотолюминесцентные исследования низкотемпературного GaAs на подложках GaAs (100) и (111)A
- Пн 2-26с** *Н. А. Байдакова, А. И. Бобров, В. М. Данильцев, М. Н. Дроздов, А. В. Новиков, Д. А. Павлов, М. В. Шалеев, П. А. Юнин, Д. В. Юрасов*
Формирование на Si(001) релаксированных слоев Ge высокого кристаллического качества

- Пн 2-27с** *П. Н. Брунков, А. В. Бакланов, Н. Д. Прасолов, А. А. Гуткин, Н. А. Калюжный, С. Г. Конников*
Эффект локальной трибоэлектризации поверхности эпитаксиального слоя n-GaAs с помощью зонда атомно-силового микроскопа
- Пн 2-28с** *В. К. Егоров, Е. В. Егоров, С. А. Кукушкин*
Исследования монокристаллических и эпитаксиальных структур силицида углерода
- Пн 2-29с** *А. П. Деточенко, С. А. Денисов, М. Н. Дроздов, А. И. Машин, В. А. Гавва, А. Д. Буланов, А. В. Нежданов, А. А. Ежеский, М. В. Степихова, В. Ю. Чалков, В. Н. Трушин, Д. В. Шенгуров, В. Г. Шенгуров, N. V. Abrosimov, H. Rietmann*
Эпитаксиально выращенные моноизотопные слои Si, Ge и Si_{1-x}Ge_x: получение и свойства
- Пн 2-30с** *Е. А. Емельянов, А. В. Васев, Б. Р. Семягин, А. П. Василенко, А. А. Команов, А. К. Гутаковский, М. А. Путьято, В. В. Преображенский*
МЛЭ твёрдых растворов InAsSb на GaAs (001): влияние молекулярной формы As на состав и кристаллическое совершенство эпитаксиальных слоев
- Пн 2-31с** *А. И. Никифоров, В. А. Тимофеев, А. Р. Туктамышев, В. И. Машанов, С. А. Тийс, М. Ю. Есин*
Влияние Sn на морфологию поверхности при росте соединений Si-Ge-Sn на Si(100) методом МЛЭ
- Пн 2-32с** *Л. С. Паришина, О. А. Новодворский, О. Д. Храмова, В. А. Михалевский, А. В. Шорохова, И. А. Петухов, Ф. Н. Путилин, М. Н. Румянцева*
Импульсное лазерное осаждение прозрачных проводящих слоев SnO₂:Sb на гибких легкоплавких органических подложках для оптоэлектронных применений
- Пн 2-33с** *Д. В. Дмитриев, А. М. Гилинский, А. И. Торопов, А. С. Кожухов, Д. В. Щеглов, А. П. Василенко, К. С. Журавлёв*
МЛЭ слоёв In_{0,52}Al_{0,48}As на подложке InP для высокочастотных фотодиодов

- Пн 2-34с** *П. В. Волков, А. В. Горюнов, А. Ю. Лукьянов, А. Д. Тertyшник, М. Н. Дроздов, А. В. Новиков, Д. В. Юрасов, Н. Н. Михайлов, Д. Г. Икусов, И. Н. Ужаков*
Оптический мониторинг технологических процессов формирования полупроводниковых структур
- Пн 2-35с** *Н. И. Подольская*
Спинодальный распад пленок ZnCdO и BeZnO
- Пн 2-36с** *А. Н. Акимов, Д. В. Ищенко, А. Э. Климов, И. Г. Неизвестный, В. Н. Шумский, В. С. Эпов*
Особенности ВАХ пленок PbSnTe:In в режиме инжекции из контактов и ограничения тока пространственным зарядом в магнитном поле: эксперимент и расчет
- Пн 2-37с** *Т. А. Багаев, М. А. Ладугин, А. А. Падалица, А. А. Мармалюк*
Легирование арсенида галлия тетрахлоридом углерода в условиях МОС-гидридной эпитаксии
- Пн 2-38с** *А. В. Шорохова, О. А. Новодворский, В. В. Рыльков, Д. А. Зуев, К. И. Маслаков, С. Н. Николаев*
Высокотемпературный ферромагнетизм в пленках $\text{Si}_{1-x}\text{Mn}_x$ ($x \approx 0.5$)
- Пн 2-39с** *А. С. Паршин, А. Ю. Изуменов, С. А. Куценков*
Количественный анализ полупроводниковых материалов методом спектроскопии потерь энергии отраженных электронов
- Пн 2-40с** *Н. Н. Михайлов, В. С. Варавин, С. А. Дворецкий, В. Г. Ремесник, Ю. Г. Сидоров*
Влияние защитного покрытия CdTe на электрофизические параметры эпитаксиальных пленок $\text{Cd}_x\text{Hg}_{1-x}\text{Te}$

3. Гетероструктуры и сверхрешетки

- Пн 3-41с** *В. Я. Алешкин, О. В. Вихрова, А. А. Дубинов, Н. В. Дикарева, Б. Н. Звонков, К. Е. Кудрявцев, С. М. Некоркин, П. А. Юнин*
Наблюдение суперлюминесценции из метаморфного GaAsSb, выращенного на GaAs

- Пн 3-42с** *Л. А. Кулакова, А. В. Лютецкий*
Деформационные исследования поляризационных свойств лазерных гетероструктур на квантовой яме и квантовых точках
- Пн 3-43с** *Т. А. Комиссарова, Г. В. Климко, С. В. Гронин, И. В. Седова, С. В. Сорокин, Б. Я. Бер, А. А. Торопов, С. В. Иванов*
Особенности электрофизических и структурных свойств гетеровалентных гетероструктур (Al)GaAs/Zn(Mn)Se
- Пн 3-44с** *Н. Е. Контева, Р. В. Чербунин, А. В. Михайлов*
Наблюдение Раби осцилляций в структуре с микрорезонатором
- Пн 3-45с** *А. Н. Яблонский, Д. И. Крыжков, С. В. Морозов, В. Я. Алешкин, Б. Н. Зонков, О. В. Вихрова, З. Ф. Красильник*
Фотолюминесценция структур с квантовыми ямами GaAsSb/GaAs и InGaAs/GaAsSb/GaAs в спектральном диапазоне 1–1,3 мкм
- Пн 3-46с** *А. А. Демнев, С. С. Гаврилов, А. С. Бричкин, А. В. Ларионов, В. Д. Кулаковский*
Темные солитоны в конденсате экситонных поляритонов в полупроводниковых микрорезонаторах при нерезонансной оптической накачке
- Пн 3-47с** *А. А. Лясота, Н. Н. Сибельдин, М. Л. Скоринов, Э. Капон, А. Рудра*
Температурная трансформация спектров фотолюминесценции квантовых ям GaAs/AlGaAs в области 2–50 К
- Пн 3-48с** *Е. С. Храмов, П. А. Белов, Ф. С. Григорьев, С. Ю. Вербин, С. Л. Яковлев*
Прямое численное решение уравнения Шредингера для экситонов в квантовых ямах
- Пн 3-49с** *В. В. Капаев*
Узкополосное детектирование и генерация гармоник терагерцевого излучения в резонансно-туннельных гетероструктурах

- Пн 3-50с** *Ф. С. Григорьев, Ю. П. Ефимов, С. А. Елисеев, И. В. Игнатъев, В. А. Ловцюс, В. В. Петров, А. В. Трифонов*
Экситоны в совершенных гетероструктурах: эксперимент и теория
- Пн 3-51с** *Д. Ю. Протасов, А. К. Бакаров, А. И. Торопов, К. С. Журавлев*
Влияние профиля δ -слоев на подвижность двумерного электронного газа, ограниченную кулоновским рассеянием, в акцепторно-легированных гетероструктурах AlGaAs/InGaAs/AlGaAs
- Пн 3-52с** *И. С. Васильевский, А. Н. Виниченко, Н. И. Каргин*
Влияние переменного профиля состава квантовой ямы $\text{In}_{y(z)}\text{Ga}_{1-y(z)}\text{As}$ на электронные транспортные свойства РНЕМТ гетероструктур
- Пн 3-53с** *А. С. Клепикова, В. Н. Неверов, Н. Г. Шелушнина, Ю. Г. Арапов, М. В. Якунин, С. В. Гудина*
Скейлинг в наноструктуре InGaAs/GaAs с двойной квантовой ямой в режиме квантового эффекта Холла
- Пн 3-54с** *И. С. Васильевский, А. Н. Виниченко, Н. И. Каргин*
Механизм немонотонной зависимости подвижности от концентрации электронов в квантовых ямах AlGaAs/InGaAs/GaAs
- Пн 3-55с** *Н. Р. Григорьева, Р. В. Григорьев, Ю. Н. Лазарева, Б. В. Новиков, А. В. Селькин*
Экситон-поляритонное излучение света из приповерхностной варизонной гетероструктуры $\text{CdS}_{1-x}\text{Se}_x/\text{CdS}$
- Пн 3-56с** *А. В. Шорохов, Н. С. Прудских, К. Н. Алексеев*
Критерий устойчивости для полупроводниковых сверхрешеток с омическими и неомическими контактами
- Пн 3-57с** *В. А. Володин, В. А. Сачков, М. П. Синюков*
Анизотропия смешанных оптических и интерфейсных фононов в сверхрешётках GaAs/AlAs: эксперимент и расчёты
- Пн 3-58с** *Ю. Ю. Романова*
Отрицательная проводимость и разогрев электронного газа в одномерных полупроводниковых сверхрешетках

- Пн 3-59с** *А. С. Большаков, В. В. Чалдышев, А. В. Бабичев, Д. А. Кудряшов, А. С. Гудовских, И. А. Морозов, М. С. Соболев, Е. В. Никитина*
Спектроскопия электроотражения резонансных брэгговских гетероструктур с квантовыми ямами InAs/GaAs
- Пн 3-60с** *З. Ш. Пирмагомедов, М. М. Гаджиалиев, Т. Н. Эфендиева*
Определение барического коэффициента дна зоны проводимости арсенида галлия
- Пн 3-61с** *М. Я. Винниченко, Д. А. Фирсов, Л. Е. Воробьев, Р. М. Балагула, М. М. Кулагина, А. П. Васильев, С. А. Dique, A. Tiutiunpnyk, V. Akimov, R. L. Restrepo*
Межподзонное поглощение и преломление света в туннельно-связанных квантовых ямах GaAs/AlGaAs в поперечном электрическом поле
- Пн 3-62с** *Д. А. Веселов, И. С. Шашкин, А. А. Подоскин, С. О. Слипченко, З. Н. Соколова, Н. А. Пихтин, И. С. Тарасов*
Методика исследования поглощения на свободных носителях в гетероструктуре мощного полупроводникового лазера
- Пн 3-63с** *А. В. Васев, Е. А. Емельянов, М. А. Путьто, Б. Р. Семягин, В. В. Преображенский*
Взаимодействие сурьмы с поверхностью InAs(001) при формировании гетерограниц InAs/GaSb методом МЛЭ
- Пн 3-64с** *Н. А. Бекин, Р. Х. Жукавин, К. А. Ковалевский, А. В. Антонов, Д. В. Козлов, М. Л. Орлов, Д. В. Юрасов, В. Н. Шастин*
Терагерцовое излучение горячих дырок при латеральном транспорте в гетероструктурах Ge/GeSi с туннельно-связанными квантовыми ямами
- Пн 3-65с** *Г. М. Борисов, В. Г. Гольдорт, А. А. Ковалёв, С. А. Кочубей, Д. В. Ледовских, В. В. Преображенский, М. А. Путьто, Н. Н. Рубцова, Б. Р. Семягин*
Генерация второй гармоники излучения фемтосекундного лазера $\text{Yb}^{3+}:\text{KY}(\text{WO}_4)_2$ в гетероструктурах A_3B_5 с асимметричными квантовыми ямами

14. Топологические изоляторы

- Пн 14-66с** *А. У. Вуков, Т. V. Murzina, N. Olivier, G. A. Wurtz, A. V. Zayats*
Сверхбыстрая динамика отклика второй оптической гармоники от поверхности топологического изолятора Bi_2Te_3
- Пн 14-67с** *И. В. Загороднев, В. В. Еналдиев, В. А. Волков*
Зависимость спектра поверхностных состояний в 2D и 3D топологических изоляторах от условий на поверхности
- Пн 14-68с** *А. В. Фролов, Ю. И. Латышев, В. А. Прудкогляд, Т. Вэйд, А. П. Орлов, В. А. Волков, В. М. Пудалов, М. Конциковский*
Эффект Ааронова-Бома и поверхностные состояния Тамма-Шокли в висмутовых нанопроволоках
- Пн 14-69с** *Е. Б. Ольшанецкий, З. Д. Квон, Г. М. Гусев, А. Д. Левин, О. Е. Райчев, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий*
Двумерный топологический изолятор в широких квантовых ямах HgTe
- Пн 14-70с** *О. Е. Терещенко, В. А. Голяшов, К. А. Кох, И. И. Климовских, А. М. Шикин, С. В. Еремеев, Е. В. Чулков*
Формирование комбинированной электронной структуры спин-поляризованных поверхностных состояний Дирака и Рашбы
- Пн 14-71с** *М. Л. Савченко, Д. А. Козлов, З. Д. Квон, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий*
Слабая антилокализация в трехмерном топологическом изоляторе на основе напряженного слоя теллурида ртути
- Пн 14-72с** *Г. В. Будкин, С. А. Тарасенко, В. В. Бельков, К.-М. Dantscher, Д. А. Козлов, P. Olbrich, C. Zoth, P. Faltermeyer, M. Lindner, З. Д. Квон, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий, D. Weiss, С. Д. Ганичев*
Эффект электронного храповика на поверхностных состояниях напряженных пленок HgTe в условиях циклотронного резонанса
- Пн 14-73с** *В. В. Глушков, А. Д. Божко, Н. О. Жаднов, С. В. Демишев, В. В. Воронов, А. В. Кузнецов, И. И. Санников, В. Б. Филиппов, Н. Ю. Шицевалова, Н. Е. Случанко*
Транспортные и магнитные свойства YbB_6

- Пн 14-74с** *Д. В. Хомицкий, А. А. Чубанов, А. В. Мишин, А. С. Козулин, А. А. Конаков*
Одномерные и нульмерные системы на основе поверхности топологических изоляторов
- Пн 14-75с** *В. И. Белявский, А. А. Горбацевич*
Спонтанная поляризация ферроэлектриков: топологические и нетопологические аспекты
- Пн 14-76с** *С. Г. Егорова, В. И. Черничкин, Л. И. Рябова, В. А. Касьян, Л. Черняк, С. Н. Данилов, Д. Р. Хохлов*
Электронный транспорт и фотоэлектрические эффекты в виртуальном кристаллическом топологическом изоляторе PbSe, модифицированном окислением
- Пн 14-77с** *В. А. Голяшов, К. А. Кох, О. А. Шегай, О. Е. Терещенко*
р-п переход в объеме и на поверхности топологических изоляторов Bi_2Te_3 и $\text{Bi}_x\text{Sb}_{2-x}\text{Te}_3$
- Пн 14-78с** *А. Ю. Дмитриев, Н. И. Федотов, В. Ф. Насретдинова, С. В. Зайцев-Зотов*
Сканирующая туннельная спектроскопия ступеней на поверхности Bi_2Se_3
- Пн 14-79с** *А. С. Козулин, А. А. Конаков*
Определение эффективной массы и скорости Ферми поверхностных состояний трехмерного топологического изолятора по данным спектроскопии уровней Ландау
- Пн 14-80с** *Л. С. Бовкун, С. С. Криштопенко, К. Е. Спирин, М. С. Жолудев, А. В. Иконников, К. В. Маремьянин, А. В. Антонов, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий, В. И. Гавриленко*
Эффективные значения g-фактора в зоне проводимости 2D топологических изоляторов
- Пн 14-81с** *Н. Н. Новикова, В. А. Яковлев, И. В. Кучеренко*
Инфракрасные спектры пленок Bi_2Se_3 на кремнии

1. Объемные полупроводники

- Вт 1-1с** *А. В. Телегин, Ю. П. Сухоруков, Н. Г. Бебенин, В. Д. Бессонов, Е. И. Патраков, В. А. Фёдоров, Т. К. Менщикова, С. В. Телегин, Н. А. Кругликов*
Магнитооптические эффекты в ИК/ТГц диапазоне в ферромагнитных полупроводниках на основе шпинели
- Вт 1-2с** *К. Е. Кудрявцев, Л. В. Красильникова, Д. В. Шенгуров, Б. А. Андреев, З. Ф. Красильник*
Спектроскопия оптического усиления и потерь в активных волноводных структурах Si:Er/SOI
- Вт 1-3с** *Т. П. Суркова, В. И. Максимов, С. Ф. Дубинин*
Неоднородно-искажённое состояние структуры сфалерита при повышенном содержании 3d- примеси в кристаллах $A^{II}B^{VI}$
- Вт 1-4с** *С. Г. Егорова, В. И. Черничкин, С. Н. Данилов, А. В. Никорич, Л. И. Рябова, Д. Р. Хохлов*
Фотоэлектромагнитный эффект в PbTe(Ga) при возбуждении импульсами терагерцового лазера
- Вт 1-5с** *В. В. Глушков, А. Д. Божко, С. В. Демидов, А. В. Духненко, А. В. Семенов, В. Б. Филиппов, Н. Ю. Шицевалова, К. Flachbart, S. Gabáni, Н. Е. Случанко*
Эффект Холла в SmB_6
- Вт 1-6с** *П. С. Вергелес, Е. Б. Якимов*
Рекомбинационно-ускоренное движение дислокаций в пленках GaN
- Вт 1-7с** *И. Г. Горлова, С. Г. Зыбцев, В. Я. Покровский, С. Ю. Гаврилкин, А. Ю. Цветков*
Эффект Холла и магнетосопротивление в слоистом квазиодномерном полупроводнике TiS_3
- Вт 1-8с** *Г. О. Андрианов, В. И. Козуб, Н. Ю. Михайлин, Р. В. Парфеньев, Д. В. Шамиур, А. В. Черняев*
Корреляция сверхпроводящих свойств твердых растворов $(Pb_zSn_{1-z})_{0.95}In_{0.05}$ с составом материала и величиной гидростатического сжатия

- Вт 1-9с** *Б. А. Андреев, П. А. Бушуйкин, В. Ю. Давыдов, А. Н. Яблонский*
Спектр фотопроводимости нитрида индия
- Вт 1-10с** *А. Н. Акимов, А. Э. Климов, И. Г. Неизвестный, В. Н. Шумский, В. С. Эпов*
Влияние магнитного поля на динамику фототока в пленках PbSnTe:In
- Вт 1-11с** *О. С. Комков, Д. Д. Фирсов, А. Н. Семёнов, В. А. Соловьёв, Т. В. Львова, И. В. Седова, С. В. Иванов*
Фотомодуляционная инфракрасная фурье-спектроскопия автоэпитаксиальных слоёв InSb
- Вт 1-12с** *Е. В. Кожемякина, Т. С. Шамирзаев, Е. А. Жуков, Д. Р. Яковлев, М. Bauer*
Электронный g-фактор и время спиновой релаксации T_2^* в высокочистых твердых растворах AlGaAs
- Вт 1-13с** *Н. Н. Агеева, И. Л. Броневова, Д. Н. Забегаев, А. Н. Кривонос*
Бистабильность автомодуляции спектра собственного стимулированного пикосекундного излучения GaAs
- Вт 1-14с** *В. П. Калинушкин, О. В. Уваров, А. А. Гладилин, Н. Н. Ильичев, В. П. Данилов, М. И. Студеникин, Е. М. Гавришук, В. Б. Иконников, С. А. Родин, Д. В. Савин, Н. А. Тимофеева*
Исследование объемных характеристик Zn-Se с помощью двухфотонной конфокальной микроскопии
- Вт 1-15с** *К. А. Ковалевский, Р. Х. Жукавин, В. Н. Шастин*
Влияние поляризации накачки на эффективность кремниевых лазеров с мелкими донорами в условиях одноосной деформации
- Вт 1-16с** *М. М. Гаджиалиев, М. И. Даунов, А. М. Мусаев*
Зависимость диэлектрической проницаемости прямозонных полупроводников от всестороннего давления
- Вт 1-17с** *И. В. Кочман, А. И. Вейнгер, Т. В. Тиснек, В. И. Окулов*
Особенности микроволнового поглощения в магнитном поле в вырожденном узкозонном полупроводнике HgSe:Fe
- Вт 1-18с** *А. М. Стрельчук*
Температурная зависимость краевой инжекционной электролюминесценции в SiC рп структурах

- Вт 1-19с** *А. С. Ильин, М. Н. Мартышов, Н. П. Фантина, П. А. Форш, П. К. Кашкаров*
Электрические и фотоэлектрические свойства нанокристаллического оксида индия с квантовыми точками CdSe
- Вт 1-20с** *А. В. Дмитриев, Н. А. Масюков*
Дрейфовая скорость электронов в сильных электрических полях в твёрдых растворах $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$ и $\text{In}_x\text{Al}_{1-x}\text{N}$
- Вт 1-21с** *А. В. Дмитриев, Е. С. Ткачёва*
Влияние зоны тяжёлых дырок на термоэлектрические величины теллурида свинца
- Вт 1-22с** *А. Г. Алибеков, А. Ю. Моллаев, Л. А. Сайпуллаева, С. Ф. Маренкин, И. В. Федорченко*
Электротранспортные явления в гранулированных структурах $\text{Cd}_3\text{As}_2+\text{MnAs}$ при высоком давлении
- Вт 1-23с** *И. К. Камиров, А. А. Степуренко, А. Э. Гумметов*
Диамagnetизм продольного автосолитона в p-InSb в продольном магнитном поле

4. Двумерные системы

- Вт 4-24с** *М. В. Якунин, А. В. Суслов, М. Р. Попов, Е. Г. Новик, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий*
Увеличенное перекрытие электронной и валентной подзон в двойной квантовой яме HgTe
- Вт 4-25с** *А. А. Кононов, С. В. Егоров, З. Д. Квон, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий, Э. В. Девятков*
Исследование транспорта между металлом с макроскопическим параметром порядка и краем двумерной электронной системы в квантовой яме HgTe с инверсией зон
- Вт 4-26с** *Ю. Б. Васильев, Н. Н. Михайлов, Г. Ю. Васильева, Ю. Л. Иванов, А. О. Захарьин, А. В. Андрианов, А. В. Антонов, А. В. Иконников, В. И. Гавриленко*
Излучение при зинеровском туннелировании в квантовых ямах HgTe
- Вт 4-27с** *З. Д. Квон, Г. М. Гусев, А. Д. Левин, Е. Е. Родякина, А. В. Латышев*
Гигантский микроволновый фотоконтактанс туннельного точечного контакта

- Вт 4-28с** *В. В. Платонов, Ю. Б. Кудасов, М. С. Жолудев, А. В. Иконников, О. Drachenko, А. С. Коршунов, И. В. Макаров, Д. А. Маслов, О. М. Сурдин, А. В. Филиппов, В. И. Гавриленко, М. Helm, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий*
Исследование магнитопоглощения в гетероструктурах HgTe/CdHgTe с квантовыми ямами в сильных магнитных полях при различных температурах
- Вт 4-29с** *Т. Б. Чарикова, Н. Г. Шелушина, Г. И. Харус, Д. С. Петухов, О. Е. Петухова, А. А. Иванов*
Скейлинг продольного и холловского электросопротивлений в двумерной электронно-легированной неупорядоченной системе
- Вт 4-30с** *В. С. Багаев, В. С. Кривобок, С. Н. Николаев*
Влияние плазменных колебаний терагерцового диапазона на спектры фотолюминесценции SiGe-гетероструктур
- Вт 4-31с** *А. В. Герт, М. О. Нестоклон, И. Н. Яссиевич*
Электронная структура и эффективный гамильтониан силицена около дираковской точки
- Вт 4-32с** *И. Н. Котельников, Е. Н. Морозова, С. Е. Дижур, Э. В. Девятов, В. Т. Долгополов*
Пиннинг уровней Ландау в туннельных спектрах двумерной электронной системы
- Вт 4-33с** *А. А. Добрецова, Л. С. Брагинский, М. В. Энтин, З. Д. Квон, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий*
Поверхностные состояния в HgTe квантовой яме и рассеяние на шероховатостях
- Вт 4-34с** *Е. Л. Румянцев*
Zitterbewegung и одночастичные уравнения Паули в двумерных дираковских полупроводниках с учетом заполнения
- Вт 4-35с** *С. И. Дорожкин*
Емкостная спектроскопия двухслойных электронных систем

- Вт 4-36с** *М. П. Михайлова, А. И. Вейнгер, П. В. Семенухин, И. В. Кочман, В. А. Березовец, А. Hospodková, J. Pangrac, M. Ziková, E. Hulicius*
Поглощение микроволнового излучения двумерными электронами в композитной квантовой яме II типа InAs/GaSb в магнитном поле
- Вт 4-37с** *Д. В. Посвянский, А. Я. Шульман*
Самосогласованный расчет непараболического энергетического спектра электронов в обогащенном слое на поверхности *n*-InAs
- Вт 4-38с** *Ю. Г. Арапов, С. В. Гудина, В. Н. Неверов, С. М. Подгорных, М. Р. Попов, Г. И. Харус, Н. Г. Шелушинина, М. В. Якунин, С. А. Дворецкий, Н. Н. Михайлов*
Эффекты 2D-локализации в режиме квантового эффекта Холла в широких квантовых ямах HgTe
- Вт 4-39с** *П. С. Алексеев, М. И. Дьяконов*
Объяснение «колоссального» отрицательного магнетосопротивления двумерной электронной жидкости
- Вт 4-40с** *Д. Б. Султанов, А. Б. Воробьев, А. Ф. Булдыгин*
Особенности магнетосопротивления двумерного электронного газа на цилиндрической поверхности под действием СВЧ-излучения
- Вт 4-41с** *В. С. Багаев, В. С. Кривобок, С. Н. Николаев, А. В. Новиков, Е. Е. Онищенко, А. А. Пручкина*
Условия возникновения сверхизлучения в видимом диапазоне в двумерных структурах SiGe/Si
- Вт 4-42с** *Е. Ю. Жданов, А. Г. Погосов, М. В. Буданцев, Д. А. Похабов, А. К. Бакаров, А. И. Торопов*
Переворот фазы осцилляций Шубникова-де Гааза в подвешенных полупроводниковых структурах
- Вт 4-43с** *А. В. Щепетильников, Ю. А. Нефёдов, И. В. Кукушкин*
Наблюдение гигантских осцилляций магнетосопротивления индуцированных микроволновым излучением в ZnO/MgZnO гетеропереходах
- Вт 4-44с** *И. В. Загороднев, Ж. А. Девизорова, В. В. Еналдиев, А. В. Фролов, В. А. Волков*
Рассеяние электронов в графене на круглом нанотверстии

- Вт 4-45с** *Н. В. Агринская, В. И. Козуб, В. А. Березовец*
Температурно-зависящий беспорядок и беспорядок, контролируемый магнитным полем: исследование применительно к системе модуляционно легированных квантовых ям
- Вт 4-46с** *Л. В. Данилов, А. А. Петухов, Э. В. Иванов, Д. В. Кузнецов, К. В. Калинина, Г. Г. Зегря, М. П. Михайлова, Ю. П. Яковлев, А. Hospodková, J. Pangrác, J. Oswald, M. Zíková, and E. Hulicius*
Излучательная рекомбинация в наногетероструктурах с глубокими квантовыми ямами при высоких температурах
- Вт 4-47с** *А. Я. Шульман*
Обменно-корреляционная энергия многоэлектронной системы в приближении самосогласованного поля
- Вт 4-48с** *В. Е. Бисти, В. А. Кузнецов, Л. В. Кулик*
Плазмороны в неравновесной системе двумерных магнитокситонов
- Вт 4-49с** *О. А. Ткаченко, В. А. Ткаченко*
Полупроводниковый дираковский резонатор в слабых магнитных полях
- Вт 4-50с** *Ю. Г. Арапов, С. В. Гудина, В. Н. Неверов, С. М. Подгорных, М. Р. Попов, Г. И. Харус, Н. Г. Шелушинина, М. В. Якунин, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий*
Температурный скейлинг в квантовом эффекте Холла в квантовой яме HgTe с инвертированным энергетическим спектром
- Вт 4-51с** *Л. Н. Овешников, В. А. Кульбачинский, Р. А. Лунин, Н. А. Юзеева, Г. Б. Галиев, С. С. Пушкарев*
Влияние структуры метаморфного буфера и ориентации подложки на подвижности электронов в двумерном канале

5. Одномерные и нульмерные системы

- Вт 5-52с** *М. А. Семина, Р. А. Сурис*
Локализованные состояния дырок в наноструктурах: магнитоиндуцированное смешивание и эффект Зеемана

- Вт 5-53с** *О. С. Кен, Д. А. Явсин, С. А. Гуревич, О. М. Сресели*
Наноконпозитные слои Si-Au и лавинное умножение в гетеропереходах на их основе
- Вт 5-54с** *Н. А. Ерюков, А. Г. Милёхин, Л. Л. Свешникова, Т. А. Дуда, Е. Е. Родякина, А. В. Латышев*
Гигантское комбинационное рассеяние света оптическими фононами в полупроводниковых нанокристаллах CuS на поверхности Au
- Вт 5-55с** *Х. Сигурдссон, О. В. Кибис, И. А. Шельх*
Оптический эффект Ааронова-Бома в квантовых кольцах
- Вт 5-56с** *А. И. Якимов, В. В. Кириенко, В. А. Армбристер, А. А. Блошкин, А. В. Двуреченский*
Локализация электронных состояний в напряженных гетероструктурах Ge/Si с квантовыми точками Ge
- Вт 5-57с** *М. П. Гамбарян, В. А. Володин, А. Г. Черков, В. И. Вдовин*
Светоизлучающие нанокристаллы $Ge_xSi_{(1-x)}$, сформированные в многослойных наноструктурах GeO/SiO₂
- Вт 5-58с** *В. Е. Минакова, А. Н. Талденков, С. В. Зайцев-Зотов*
Низкотемпературная проводимость и фотопроводимость пайерлсовского проводника *o*-TaS₃ при одноосном растяжении
- Вт 5-59с** *А. А. Лямкина, С. П. Мощенко, Д. В. Дмитриев, А. И. Торопов*
Коллективные эффекты в экситон-плазмонном взаимодействии в структурах с InAs/AlGaAs КТ и кластерами индия
- Вт 5-60с** *В. П. Кочерешко, В. Н. Кац, А. В. Платонов, А. Н. Поддубный, Г. Э. Цырлин, А. Д. Буравлев*
Спектроскопия одиночной квантовой точки, заключенной в одиночную квантовую нить
- Вт 5-61с** *А. А. Зарубанов, К. С. Журавлев*
Температурная зависимость времени жизни в нанокристаллах CdS, сформированных методом Ленгмюра-Блоджетт
- Вт 5-62с** *Р. М. Балагула, Л. Е. Воробьев, Д. А. Фирсов, А. Н. Софронов, А. А. Тонких*
Релаксация фотоиндуцированного поглощения света среднего ИК диапазона в квантовых точках $Ge_{1-x}Si_x/Si$

- Вт 5-63с** *М. В. Еременко, А. Н. Резницкий, А. М. Минтаиров, J. Karaldo, J. Merz*
Экситоны в самоорганизованных CdSe/ZnSe квантовых точках: температурная зависимость формы спектров излучения и пространственная размерность излучающих состояний
- Вт 5-64с** *С. В. Сорокин, Т. В. Шубина, И. В. Седова, С. В. Гронин, А. В. Родина, М. А. Семина, А. А. Головатенко, М. В. Рахлин, А. А. Ситникова, А. А. Торопов, С. В. Иванов*
Управление спектром излучательных состояний в массивах квантовых точек CdSe/ZnSe, сформированных методами молекулярно-пучковой эпитаксии
- Вт 5-65с** *Д. С. Абрамкин, К. М. Румынин, Е. А. Емельянов, А. К. Бакаров, М. А. Путьато, А. К. Гутаковский, Б. Р. Семягин, В. В. Преображенский, Т. С. Шамирзаев*
Энергетический спектр самоорганизованных III-Sb/AlAs квантовых точек
- Вт 5-66с** *П. И. Арсеев, Н. С. Маслова, В. Н. Манцевич*
Влияние кулоновских корреляций на особенности туннельных характеристик примесных комплексов и сильно связанных квантовых точек
- Вт 5-67с** *И. В. Крылов, К. А. Дроздов, А. С. Чижов, М. Н. Румянцева, Р. Б. Васильев, Д. Р. Хохлов, Д. Г. Филатова, А. М. Абакумов, А. М. Гаськов*
Полупроводниковые газовые сенсоры на основе оксида цинка с квантовыми точками селенида кадмия
- Вт 5-68с** *Д. М. Самосват, О. П. Чикалова-Лузина, Г. Г. Зегря*
Безызлучательный резонансный перенос энергии в полупроводниковых квантовых точках
- Вт 5-69с** *А. В. Бакланов, А. А. Гуткин, П. Н. Брунков, А. Ю. Егоров, С. Г. Конников*
Анализ процессов термической эмиссии носителей заряда из массивов InAs квантовых точек в слое объемного заряда GaAs матрицы
- Вт 5-70с** *А. П. Болтаев, Ф. А. Пудонин*
Диэлектрические свойства nanoостровковых систем с туннельным характером проводимости

- Вт 5-71с** *И. А. Александров, В. Г. Мансуров, К. С. Журавлев*
 Модель температурного тушения фотолюминесценции структур с квантовыми точками GaN/AlN
- Вт 5-72с** *А. И. Якимов, В. В. Кириенко, В. А. Тимофеев, А. В. Дзуреченский*
 Двухнаправленный фототок дырок в слоях квантовых точек Ge/Si
- Вт 5-73с** *А. А. Головатенко, М. А. Семина, А. В. Родина, Т. В. Шубина*
 Моделирование спектров фотолюминесценции неоднородных массивов эпитаксиальных квантовых точек CdSe/ZnSe
- Вт 5-74с** *С. А. Тарасов, И. И. Михайлов, И. А. Ламкин, А. С. Евсеенков, А. В. Соломонов*
 Оптические свойства наносистем «коллоидные квантовые точки PbS – матрицы пористого кремния»
- Вт 5-75с** *А. В. Савельев, М. В. Максимов, А. Е. Жуков*
 Стабильность спектра излучения ансамблей полупроводниковых квантовых точек
- Вт 5-76с** *В. В. Вальков, С. В. Аксенов*
 Вольт-амперная характеристика джозефсоновского перехода, сформированного регулярной структурой спиновых димеров
- Вт 5-77с** *В. Я. Алешкин, О. В. Вихрова, А. А. Дубинов, Н. В. Дикарева, Б. Н. Звонков, С. М. Некоркин, А. Н. Яблонский*
 Наблюдение фотолюминесценции квантовых точек InAs, выращенных на метаморфном буфере GaAsSb
- Вт 5-78с** *К. Л. Кошелев, В. Ю. Качоровский*
 Оптическое возбуждение циркулярного тока в неупорядоченном квантовом кольце

8. Высокочастотные явления в полупроводниках

- Вт 8-79с** *О. А. Ткаченко, В. А. Ткаченко*
 Многофотонные эффекты в прохождении электрона через плавный барьер в микроволновом поле

- Вт 8-80с** *А. В. Андрианов, А. О. Захарьин, В. И. Санкин, Ю. Б. Васильев*
Примесная ТГц люминесценция, индуцированная инъекцией неравновесных носителей заряда в легированных полупроводниках
- Вт 8-81с** *М. А. Ормонт, И. П. Звягин*
Особенности частотной зависимости проводимости неупорядоченных полупроводников в режиме прыжковой проводимости с постоянной длиной прыжка
- Вт 8-82с** *А. А. Горбачевич, В. И. Егоркин, И. П. Казаков, В. В. Капаев, В. Н. Мурзин, С. А. Савинов*
Детектирование суб-ТГц излучения асимметричными резонансно-туннельными наноструктурами при нулевом смещении

10. Углеродные наноматериалы

- Вт 10-83с** *А. Д. Заболотский, Ю. Е. Лозовик*
Псевдомагнитное поле в деформированном дираковском материале
- Вт 10-84с** *А. А. Грешинов, Я. М. Бельтюков*
Теория квантового эффекта Холла в графене при 300 К
- Вт 10-85с** *Г. Ю. Васильева, Д. Смирнов, Ю. Б. Васильев, Ю. Л. Иванов, Р. Хауг*
Линейное магнетосопротивление в двухслойном графене
- Вт 10-86с** *С. Л. Коваленко, Б. В. Андрюшечкин, Т. В. Павлова, К. Н. Ельцов*
Формирование монокристаллов графена на поверхности Ni(111) методом температурно-программируемого синтеза
- Вт 10-87с** *Г. В. Тихомирова, Т. К. Петросян, А. В. Тебеньков*
Фазовые переходы в графите и графене при холодном сжатии
- Вт 10-88с** *В. Ю. Давыдов, А. Н. Смирнов, В. М. Микушкин, С. П. Лебедев, А. А. Лебедев*
Влияние дефектов и примесных комплексов, создаваемых контролируемым образом, на оптические и электрофизические свойства графена, синезированного на 6H-SiC

- Вт 10-89с** *Г. Ю. Васильева, Ю. Б. Васильев, Ю. Л. Иванов, С. Новиков, С. Данилов*
Терагерцовая фотопроводимость структур на основе эпитаксиального графена
- Вт 10-90с** *А. Л. Вихарев, А. Б. Мучников, Д. Б. Радищев, С. А. Богданов, В. А. Исаев, О. А. Иванов, А. М. Горбачев*
Комбинированные подложки моно- и поликристаллического полупроводникового CVD алмаза большой площади
- Вт 10-91с** *С. В. Голод, М. А. Сергеев, В. А. Володин, А. И. Комонов, Р. А. Соотс, В. Я. Принц*
Влияние высокотемпературных отжигов на морфологию поверхности меди и выращенного графена
- Вт 10-92с** *О. И. Хрыкин, Ю. Н. Дроздов, М. Н. Дроздов, П. А. Юнин, В. И. Шашкин, С. А. Богданов, А. Б. Мучников, А. Л. Вихарев, Д. Б. Радищев, В. В. Чернов*
Рост нанокристаллических алмазных пленок на монокристаллическом AlN

Стендовая сессия III

Среда

18:00–20:00

6. Спиновые явления, спинтроника, наномагнетизм

- Ср 6-1с** *И. В. Крайнов, В. Ф. Сапега, Н. С. Аверкиев, Г. С. Димитриев, К. Н. Ploog*
Механизмы спиновой релаксации марганца в ферромагнитном (Ga,Mn)As
- Ср 6-2с** *А. В. Ненашев, А. Ф. Зиновьева, А. В. Двуреченский, Т. С. Зароднюк, А. Ю. Горнов*
О возможности выполнения квантовых логических операций в системе двух электронов, локализованных на Ge квантовой точке
- Ср 6-3с** *Е. Л. Ивченко, Л. А. Бакалейников, В. К. Калевич*
Спин-зависимая рекомбинация и сверхтонкое взаимодействие на глубоких парамагнитных дефектах
- Ср 6-4с** *И. И. Ляпилин, М. С. Окороков*
О генерации спин-волнового тока в гибридных наноструктурах

- Ср 6-5с** *А. П. Деточенко, А. В. Сухоруков, Д. В. Гусейнов, А. В. Кудрин, С. А. Попков, А. В. Королева, А. А. Ежеский, А. А. Конаков, В. А. Бурдов, Д. Г. Зверев, Г. В. Мамин, Н. В. Абросимов, Н. Riemann*
Спиновый транспорт и спиновый резонанс с участием мелких доноров в кремнии
- Ср 6-6с** *А. В. Здоровейцев, М. В. Дорохин, П. Б. Демина, Ю. А. Данилов, А. В. Кудрин, Е. А. Питуримова, А. Г. Темирязов, М. П. Темирязева, F. Iikawa*
Спиновые светоизлучающие диоды на основе наноразмерных структур InGaAs/GaAs с ферромагнитным инжектором CoPt
- Ср 6-7с** *Д. С. Смирнов, Л. Е. Голуб*
Динамика и флуктуации спина в режиме стриминга
- Ср 6-8с** *И. А. Кокурин, Н. С. Аверкиев*
Ориентация спинов носителей током в квази-одномерной системе
- Ср 6-9с** *А. В. Пошакинский, С. А. Тарасенко*
Распространение термических флуктуаций спиновой плотности в квантовых ямах
- Ср 6-10с** *Ж. А. Девизорова, В. А. Волков*
Спин-орбитальное взаимодействие электронов с атомарно резкой гетерограницей в квантовой яме
- Ср 6-11с** *Е. В. Филатов, А. А. Максимов, И. И. Тартаковский*
Прямые измерения пикосекундной кинетики нагрева спиновой подсистемы Mn в полумагнитных полупроводниковых гетероструктурах типа-II (Zn,Mn)Se/BeTe
- Ср 6-12с** *А. Н. Афанасьев, А. А. Грешинов, Г. Г. Зегря*
Генерация чисто спиновых токов при Оже-рекомбинации в квантовых ямах с расщеплением Рашбы и Дрессельхауса
- Ср 6-13с** *Л. В. Котова, А. В. Платонов, В. Н. Кац, Л. Е. Голуб, В. П. Кочерешко, Е. В. Кожемякина, Д. В. Дмитриев*
Эффекты пространственной дисперсии в структурах с квантовыми ямами
- Ср 6-14с** *М. М. Глазов*
Конкуренция сверхтонкого взаимодействия и прыжков в спиновом шуме локализованных электронов

- Ср 6-15с** *В. Ф. Сапега, Г. С. Димитриев, И. В. Крайнов, Н. С. Аверкиев*
Расщепление состояний акцептора марганца в $(\text{Ga},\text{Mn})\text{As}$ в деформационном и магнитном полях
- Ср 6-16с** *К. Ю. Черноглазов, А. С. Семисалова, С. Н. Николаев, В. В. Рыльков, В. В. Тугушев, Ю. М. Чесноков, А. Л. Васильев, И. А. Лихачев, Э. М. Пашаев, А. В. Зенкевич, Ю. А. Матвеев, О. А. Новодворский, А. В. Шорохова, Н. С. Перов, Э. Т. Кулатов, А. С. Веденеев, А. С. Бугаев*
Ферромагнетизм поликристаллических пленок $\text{Si}_{1-x}\text{Mn}_x$ ($x \sim 0,5$) с самоорганизованным распределением кристаллитов по размерам
- Ср 6-17с** *О. Е. Терещенко, В. А. Голяшов, И. Б. Чистохин, Т. С. Шамирзаев, А. С. Ярошевич, И. А. Дерезев, В. А. Гайслер, А. К. Бакаров, Д. В. Дмитриев, А. И. Торопов, И. И. Мараховка, А. В. Коптилов, Н. В. Кислых*
Инжекция свободных спин-поляризованных электронов в гетероструктуры на основе A^3B^5
- Ср 6-18с** *К. Г. Гареев, С. А. Ионин, В. А. Мошников, Н. В. Пермьяков*
Исследование коллоидных частиц $\text{Fe}_m\text{O}_n\text{-SiO}_2$, получаемых одно- и двухстадийным способами
- Ср 6-19с** *А. В. Черненко, А. С. Бричкин*
Локализованные и связанные экситоны в сверхрешётках второго типа $\text{ZnMnSe}/\text{ZnSSe}$
- Ср 6-20с** *А. А. Лотин, О. А. Новодворский, М. А. Панков, В. В. Рыльков, Э. Т. Кулатов, Д. А. Зуев, О. Д. Храмова, Л. С. Паршина, А. В. Шорохова, В. А. Михалевский, Е. А. Черобыло*
Магнитная анизотропия в тонких пленках $\text{Zn}_{1-x}\text{Co}_x\text{O}$
- Ср 6-21с** *О. А. Новодворский, Л. С. Паршина, О. Д. Храмова, В. А. Михалевский, С. Ф. Маренкин, И. В. Федорченко, А. Н. Аронов, Б. А. Аронзон*
Создание магнитных полупроводниковых гетеропереходов $p\text{-In}_{1-x}\text{Mn}_x\text{Sb}/n\text{-InSb}$ методом импульсного лазерного осаждения

7. Примеси и дефекты

- Ср 7-22с** *Н. С. Аверкиев, I. B. Bersuker, В. В. Гудков, S. Zherlitsyn, S. Yasin, И. В. Жевстовских, К. А. Барышников, А. М. Монахов, М. Н. Сарычев, Ю. В. Коростелин*
Ультразвуковое определение параметров эффекта Яна-Теллера в полупроводниковом кристалле CdSe:Cr^{2+}
- Ср 7-23с** *В. Я. Алешкин*
Динамика примесной фотопроводимости в гетероструктуре GaAs/AlGaAs с квантовыми ямами
- Ср 7-24с** *О. А. Солтанович, Е. Б. Якимов, Й. Вебер*
Исследование метастабильных дефектов в эпитаксиальных слоях n-GaAs методом высокоразрешающей Лапласовской релаксационной спектроскопии глубоких уровней
- Ср 7-25с** *В. С. Багаев, В. С. Кривобок, С. Н. Николаев, Е. Е. Онищенко, А. А. Пручкина, А. А. Савинова, Н. А. Смирнова*
Оптическая спектроскопия комплексных дефектов в компенсированных кристаллах Cd(Zn)Te
- Ср 7-26с** *В. В. Козловский, Б. Я. Бер, Е. В. Богданова, Н. В. Середова, А. А. Лебедев*
Особенности радиационного дефектообразования в 6Н- и 4Н-SiC n- и р- типа проводимости
- Ср 7-27с** *Л. В. Арапкина, М. С. Сторожевых, К. В. Чиж, В. А. Чапнин, В. А. Юрьев*
Формирование наноразмерных дефектов роста на поверхности Si/Si(001) в процессе МЛЭ
- Ср 7-28с** *Е. П. Скипетров, М. М. Маркина, К. В. Захаров, А. А. Соловьев, А. В. Кнотько, Е. И. Слынько, В. Е. Слынько*
Магнитные свойства разбавленных магнитных полупроводников $\text{Pb}_{1-y}\text{Fe}_y\text{Te}$
- Ср 7-29с** *А. Н. Акимов, Д. В. Ищенко, А. Э. Климов, И. Г. Неизвестный, В. Н. Шумский, В. С. Эпов*
Термостимулированные токи в PbSnTe:In при заполнении центров захвата освещением и инжекцией из контактов

- Ср 7-30с** *И. И. Ижнин, Е. И. Фицыч, А. В. Войцеховский, А. Г. Коротаев К. Д. Мынбаев, В. С. Варавин, С. А. Дворецкий, Н. Н. Михайлов, М. В. Якушев, А. Ю. Бончик, Г. В. Савицкий, Z. Świątek, P. Ozga*
Электrofизические и оптические исследования нейтральных дефектов в эпитаксиальных пленках $Cd_xHg_{1-x}Te$
- Ср 7-31с** *Л. Б. Карлина, А. С. Власов, Б. Я. Бер, Д. Ю. Казанцев, М. М. Кулаг*
Роль изовалентных сурфактантов в процессах диффузии цинка в арсениде галлия
- Ср 7-32с** *В. П. Мартовицкий, Ю. Г. Садофьев*
Рентгенодифракционное выявление повышенной концентрации точечных дефектов в эпитаксиальных слоях $Si_{1-x}Ge_x$ и $Ge_{1-x}Sn_x$
- Ср 7-33с** *В. В. Цыпленков, В. Н. Шастин*
Механизм инверсии при оптическом возбуждении двойных доноров магния в кремнии
- Ср 7-34с** *В. И. Зубков, О. В. Кучерова, А. В. Зубкова, J. Butler, А. Л. Вихарев, С. А. Богданов*
Исследования примесного уровня бора в полупроводниковом алмазе методом температурной спектроскопии адмиттанса
- Ср 7-35с** *Ю. В. Жилев, В. В. Зеленин, Е. Н. Мохов, С. С. Нагалюк, Н. К. Полетаев, А. П. Скворцов*
Спектры поглощения кристаллов нитрида алюминия, легированных ионами Eg^{3+}
- Ср 7-36с** *И. А. Курова, Н. Н. Ормонт*
Релаксация метастабильной темновой проводимости пленок аморфного гидрированного кремния, фотоиндуцированной при температурах выше 400 К
- Ср 7-37с** *И. В. Осинных, Т. В. Малин, В. Ф. Плюснин, К. С. Журавлев*
Исследование сине-зеленой полосы в спектрах фотолюминесценции сильно легированного $Al_xGa_{1-x}N$
- Ср 7-38с** *О. С. Трушин, Э. Марас, Т. Ала-Ниссила, Э. Гранато, С. Ч. Инг*
Атомные механизмы зарождения дислокаций в гетероэпитаксиальной структуре $Ge/Si(001)$

- Ср 7-39с** *А. А. Алтухов, Ю. В. Гуляев, Н. Х. Талипов, Р. А. Хмельницкий, Г. В. Чучева*
Особенности активации бора, имплантированного при больших дозах в природные кристаллы алмаза
- Ср 7-40с** *А. Э. Климов, Н. С. Пащин, В. Н. Шерстякова, В. Н. Шумский*
Длинноволновая ИК фотопроводимость пленок $Pb_{1-x}Sn_xTe:In$ для составов вблизи инверсии зон
- Ср 7-41с** *Е. В. Иванова, М. В. Заморянская, М. Г. Мынбаева*
Точечные дефекты в объемном GaN

9. Органические полупроводники, молекулярные системы

- Ср 9-42с** *Е. С. Жукова, A. Pustogow, M. Pinterić, S. Tomić, J. A. Schlueter, Б. П. Горшунов, M. Dressel*
Низкоэнергетические возбуждения в спин-жидкостном соединении $\kappa-(BEDT-TTF)_2Cu_2(CN)_3$
- Ср 9-43с** *В. В. Травкин, Г. Л. Пахомов, В. И. Шашкин, П. А. Стужин*
Многослойные структуры с изотипным молекулярным гетеропереходом
- Ср 9-44с** *С. В. Новиков*
Прыжковый транспорт носителей заряда в материалах с пространственно коррелированной экспоненциальной плотностью состояний
- Ср 9-45с** *А. С. Берестенников, П. С. Крылов, А. Н. Алёшин*
Композитные плёнки на основе биоцеллюлозы, модифицированной проводящим полимером PEDOT/PSS
- Ср 9-46с** *А. Б. Гордеева, И. В. Макаренко, В. П. Улин, В. Л. Берковиц*
Влияние свойств подложки на формирование кристаллитов фталоцианина меди
- Ср 9-47с** *Р. Т. Сибатов, Е. В. Морозова*
Дисперсионная адвекция-диффузия носителей заряда в полимерных мультислоях
- Ср 9-48с** *М. Н. Журавлёв, А. А. Горбацевич, Т. С. Катаева*
Молекулярный переключатель на основе транс-полиацетилена

11. Метаматериалы и фотонные кристаллы. Нанофотоника

- Ср 11-49с** *М. В. Стетихова, С. М. Сергеев, В. А. Вербус, А. В. Новиков, З. Ф. Красильник, М. В. Шалеев, И. И. Амиров, J. G. Schilling*
Модовый состав и люминесцентные свойства дисковых микрорезонаторов, сформированных на базе светоизлучающих структур с наноостровками Ge(Si)
- Ср 11-50с** *В. Л. Крутянский, А. Л. Чехов, А. И. Стогний, Т. В. Мурзина*
Нелинейно-оптические эффекты в Au/BIG магнитоплазмонных кристаллах
- Ср 11-51с** *В. И. Ушанов, В. В. Чалдышев, Н. А. Берт, В. Н. Неведомский, Н. Д. Ильинская, Н. М. Лебедева, М. А. Яговкина, В. В. Преображенский, М. А. Путьто, Б. Р. Семягин*
Плазмонный резонанс в новых металло-полупроводниковых метаматериалах AsSb-AlGaAs
- Ср 11-52с** *Л. С. Голобокова, Ю. В. Настаушев, Ф. Н. Дульцев, Н. В. Крыжановская, Э. И. Моисеев, А. Б. Талочкин, В. А. Сейфи, А. В. Латышев*
Экспериментальное исследование и численное моделирование оптических характеристик кремниевых нанопилларов
- Ср 11-53с** *М. Ю. Барабаненков, В. Т. Волков, А. Н. Грузинцев, А. И. Ильин, О. В. Трофимов*
Асимметричная структура из двух дифракционных решеток для ввода ИК излучения в Si полосковый волновод
- Ср 11-54с** *М. Ю. Барабаненков, Ю. Н. Барабаненков*
Передача возбуждения вдоль 1D линейной цепочки плазмонных сферических наночастиц
- Ср 11-55с** *В. К. Егоров, Е. В. Егоров*
Особенности рентгеновской нанофотоники в условиях воздействия оптического излучения

12. Полупроводниковые приборы и устройства

- Ср 12-56с** ***К. В. Чиж, В. А. Юрьев, В. А. Чапнин, О. В. Уваров, В. П. Калинушкин***
Неохлаждаемые микроболометры на основе диодов Шоттки
- Ср 12-57с** ***В. Г. Кеслер, А. А. Гузев, С. А. Дворецкий, Е. Р. Закиров, А. П. Ковчавцев, З. В. Панова, М. В. Якушев***
Изготовление и фотоэлектрические характеристики туннельных МОП диодов на КРТ
- Ср 12-58с** ***М. А. Ладугин, Т. А. Багаев, И. В. Яроцкая, А. А. Падалица, А. А. Мармалюк, А. Д. Максимов***
Гетероструктуры с квантовыми ямами (Al)GaAs и (In)GaAsP для мощных полупроводниковых лазерных излучателей спектрального диапазона 780-810 нм
- Ср 12-59с** ***Н. А. Пихтин, С. О. Слипченко, И. С. Тарасов***
Внутренние оптические потери в полупроводниковых лазерах
- Ср 12-60с** ***О. В. Наумова, Э. Г. Зайцева, Б. И. Фомин, М. А. Ильницкий, В. П. Попов***
Подвижность электронов в двухзатворных тонкопленочных КНИ-МОП транзисторах
- Ср 12-61с** ***Н. В. Крыжановская, Ю. В. Кудашова, Э. И. Моисеев, А. Е. Жуков, М. В. Максимов, М. М. Кулагина, С. И. Трошков, А. А. Липовский, Д. В. Карпов***
Микролазеры анизотропной формы с активной областью на основе InAs/InGaAs квантовых точек
- Ср 12-62с** ***С. А. Рожков, С. Н. Косолобов, Г. Э. Шайблер, А. С. Терехов, В. А. Курешов, Д. Р. Сабитов, А. В. Мазалов, А. А. Падалица, А. В. Долгих, А. В. Чикинев, С. В. Гамзинов, И. И. Гольдберг***
Вклад электронных ловушек в темновой ток p -GaN(Cs,O) фотокатода
- Ср 12-63с** ***С. О. Слипченко, А. А. Подоскин, А. В. Рожков, Н. А. Пихтин, И. С. Тарасов, Т. А. Багаев, М. А. Ладугин, А. А. Мармалюк, А. А. Падалица, В. А. Симаков***
Мощные импульсные лазеры-тиристоры на основе AlGaAs/GaAs гетероструктур (900 нм)

- Ср 12-64с** *С. В. Сорокин, Г. В. Климко, С. В. Гронин, И. В. Седова, А. А. Ситникова, А. А. Торопов, Е. А. Европейцев, С. В. Иванов*
Молекулярно-пучковая эпитаксия короткопериодных сверхрешеток Zn(S)Se/CdSe/In_{0,3}Ga_{0,7}As с эффективной шириной запрещенной зоны 2,1-2,15 эВ
- Ср 12-65с** *Н. Ю. Гордеев, А. С. Паюсов, Ю. М. Шерняков, Н. А. Калюжный, С. А. Минтауров, М. В. Максимов*
Управление модовым составом излучения торцевых полупроводниковых лазеров с резонансно-связанными волноводами
- Ср 12-66с** *Д. В. Гуляев, К. С. Журавлев, А. К. Бакаров, А. И. Торопов, Д. Ю. Протасов, Б. Я. Бер, Д. Ю. Казанцев*
Влияние легирования барьерных слоев AlGaAs бериллием на свойства *p*-HEMT AlGaAs/InGaAs/AlGaAs гетероструктур
- Ср 12-67с** *М. А. Бобров, С. А. Блохин, А. Г. Кузьменков, Н. А. Малеев, А. А. Блохин, А. П. Васильев, А. Г. Гладышев, В. М. Устинов*
Контроль поляризации выходного излучения вертикально-излучающих лазеров спектрального диапазона 850 нм с ромбовидной токовой апертурой и внутррезонаторными контактами
- Ср 12-68с** *А. А. Мармалюк, А. В. Мазалов, В. А. Курешов, Д. Р. Сабитов, А. А. Падалица, Р. Х. Акчурин*
Гетероструктуры III-N для приборов полупроводниковой фотоэлектроники
- Ср 12-69с** *М. С. Иванов, П. Б. Родин, П. А. Иванов, И. В. Грехов*
Волна ионизации TRAPATT-типа в карбидкремниевых и кремниевых пикосекундных лавинных обострителях
- Ср 12-70с** *Г. М. Борисов, В. Г. Гольдорт, С. А. Кочубей, Д. В. Ледовских, А. А. Ковалёв, М. Н. Путято, В. В. Преображенский, Н. Н. Рубцова, Б. Р. Семягин, Т. С. Шамирзаев*
Наноструктуры A³B⁵ для пассивной синхронизации мод лазеров

- Ср 12-71с** *В. П. Попов, М. А. Ильницкий, В. Н. Мордкович, А. В. Леонов*
Квантовые поправки в эффекте линейной зарядовой связи порогов двухзатворных КНИ транзисторов толщиной до 200 нм
- Ср 12-72с** *А. А. Дубинов С. С. Криштопенко, М. С. Жолудев, В. Я. Алешкин*
Возможность стимулированного терагерцового излучения из HgCdTe структур с квантовыми ямами
- Ср 12-73с** *С. М. Некоркин, Б. Н. Звонков, Н. В. Дикарева, В. Г. Шенгуров, С. А. Денисов, А. А. Дубинов, В. Я. Алешкин, К. Е. Кудрявцев, З. Ф. Красильник*
Стимулированное излучение в InGaP/GaAs/InGaAs структуре на Ge/Si подложке
- Ср 12-74с** *А. П. Ковчавцев, В. Г. Кеслер, А. А. Гузев, А. В. Царенко, З. В. Панова*
Температурные зависимости адмиттанса InAs-МОП структур со сверхтонким окислом
- Ср 12-75с** *П. А. Иванов, О. И. Коньков, А. С. Потапов, Т. П. Самсонова*
Электрическое сопротивление барьерных контактов Ti/n-4H-SiC при высоких плотностях прямого тока
- Ср 12-76с** *А. А. Алтухов, Ю. В. Гуляев, К. Н. Зяблюк, Н. Х. Талипов, Г. В. Чучева*
Формирование дельта легированного *p*-слоя в природных и CVD кристаллах алмаза при термообработках в водороде
- Ср 12-77с** *О. Г. Кошелев, Г. Г. Унтила*
О времени релаксации фотопроводимости в базовой области кремниевых солнечных элементов при локальном освещении
- Ср 12-78с** *Д. В. Горшков, В. В. Бакин, С. А. Рожков, Г. Э. Шайблер, С. Н. Косолюбов, А. С. Терехов*
Упругое и неупругое рассеяние фотоэлектронов при фотоэмиссии из *p*-GaN(Cs,O) и *p*-GaAs(Cs,O) фотокатодов
- Ср 12-79с** *П. Н. Брунков, В. И. Брылевский, И. А. Смирнова, П. Б. Родин, И. В. Грехов*
Глубокие уровни в диодных структурах кремниевых лавинных обострителей субнаносекундного диапазона

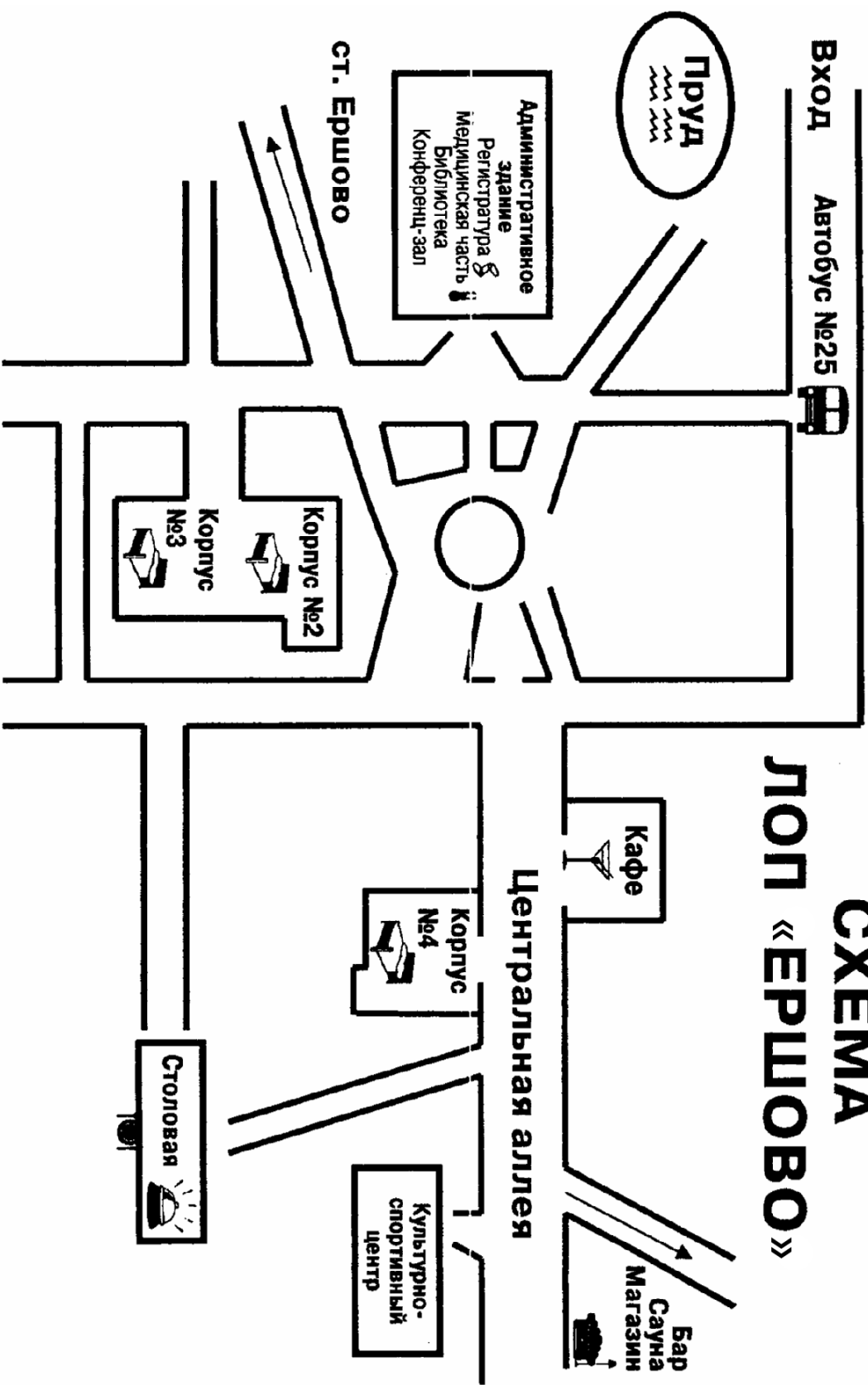
- Ср 12-80с** *О. А. Солтанович, Е. Б. Якимов*
Анализ частотных зависимостей вольт-фарадных характеристик и адмиттанса светоизлучающих структур InGaN/GaN: влияние процессов релаксации заряда в квантовых ямах
- Ср 12-81с** *М. Е. Бойко, М. Д. Шарков, А. М. Бойко, А. В. Бобыль, С. Г. Конников*
Исследование сверхструктур в полупроводниковых приборах методом МУРР при длинах волн около краев поглощения элементов образца
- Ср 12-82с** *М. А. Демьяненко, Д. Г. Есаев, А. И. Козлов, А. Р. Новоселов, В. Н. Овсяк*
Мозаичные фотоприемники обзорно-панорамного формата: разработка, применение и некоторые системные вопросы
- Ср 12-83с** *Г. М. Борисов, В. Г. Гольдорт, А. А. Ковалёв, Д. В. Ледовских, Н. Н. Рубцова*
Техника двойной модуляции в исследовании кинетики поглощения/отражения полупроводниковых наноструктур
- Ср 12-84с** *В. В. Золотарев, А. Ю. Лешко, Н. А. Пихтин, С. О. Слипченко, И. С. Тарасов*
Полупроводниковые лазеры с поверхностным распределенным брэгговским зеркалом высокого порядка дифракции
- Ср 12-85с** *И. А. Андреев, В. В. Дюделев, Н. Д. Ильинская, Г. Г. Коновалов, Е. В. Куницына, О. Ю. Серебренникова, Г. С. Соколовский, В. В. Шерстнев, Ю. П. Яковлев*
Сверхбыстродействующие (полоса пропускания 2-10 ГГц) фотодиоды для спектрального диапазона 1,3-3,8 мкм
- Ср 12-86с** *И. Г. Пашаев*
Исследование релаксации избыточного тока кремниевых диодов Шоттки, изготовленного с применением различных аморфных металлических сплавом

- Ср 12-87с** *А. Ю. Егоров, А. В. Бабичев, Л. Я. Карачинский, И. И. Новиков, Н. А. Пихтин, И. С. Тарасов, Е. В. Никитина, А. Н. Софронов, Д. А. Фирсов, Л. Е. Воробьев, М. Tchernycheva, A. Bousseksou*
Генерация излучения с длиной волны 5.8 мкм многопериодными квантово-каскадными лазерами при комнатной температуре
- Ср 12-88с** *З. Н. Соколова, К. В. Бахвалов, А. В. Лютецкий, Н. А. Пихтин, И. С. Тарасов, Л. В. Асрян*
Метод определения скорости захвата носителей заряда в квантовую яму в полупроводниковом лазере
- Ср 12-89с** *М. Д. Шарков, М. Е. Бойко, А. В. Бобыль, А. М. Бойко, С. Г. Конников*
Исследования размеров в доменно-кластерной структуре GaN/SiC и пористого SiC — материалов для полупроводниковых лазеров

13. Наномеханика

- Ср 13-90с** *А. Н. Куприянов, О. С. Трушин, И. И. Амиров*
Моделирование методом молекулярной динамики колебаний медных нанорезонаторов
- Ср 13-91с** *И. В. Уваров, О. М. Королева, В. В. Наумов*
МЭМС-переключатель электростатического типа с механизмом активного размыкания электродов
- Ср 7-92с** *Э. А. Штейнман, А. В. Терещенко, В. В. Привезенцев*
Фотолюминесценция в кремнии, имплантированном ионами цинка

СХЕМА ЛОП «ЕРШОВО»



Подписано в печать 05.08.2015 г.
Формат 60x84/16 Заказ №40. Тираж 380 экз. Пл 4
Отпечатано в РИИС ФИАН с оригинал-макета заказчика
119991 Москва, Ленинский проспект, 53. Тел. 4997833640